

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY  
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—oo—



---

HOMEWORK REPORT

## Chapter 1 - Amplifiers and Pulse Circuits

---

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

**List of Members**

| STT | MSSV    | Họ Và Tên            | Lớp |
|-----|---------|----------------------|-----|
| 1   |         | Đoàn Ngọc Sang       | L02 |
| 2   | 2210780 | Nguyễn Đại Đồng      | L02 |
| 3   |         | Trần Nguyễn Trâm Ánh | L02 |

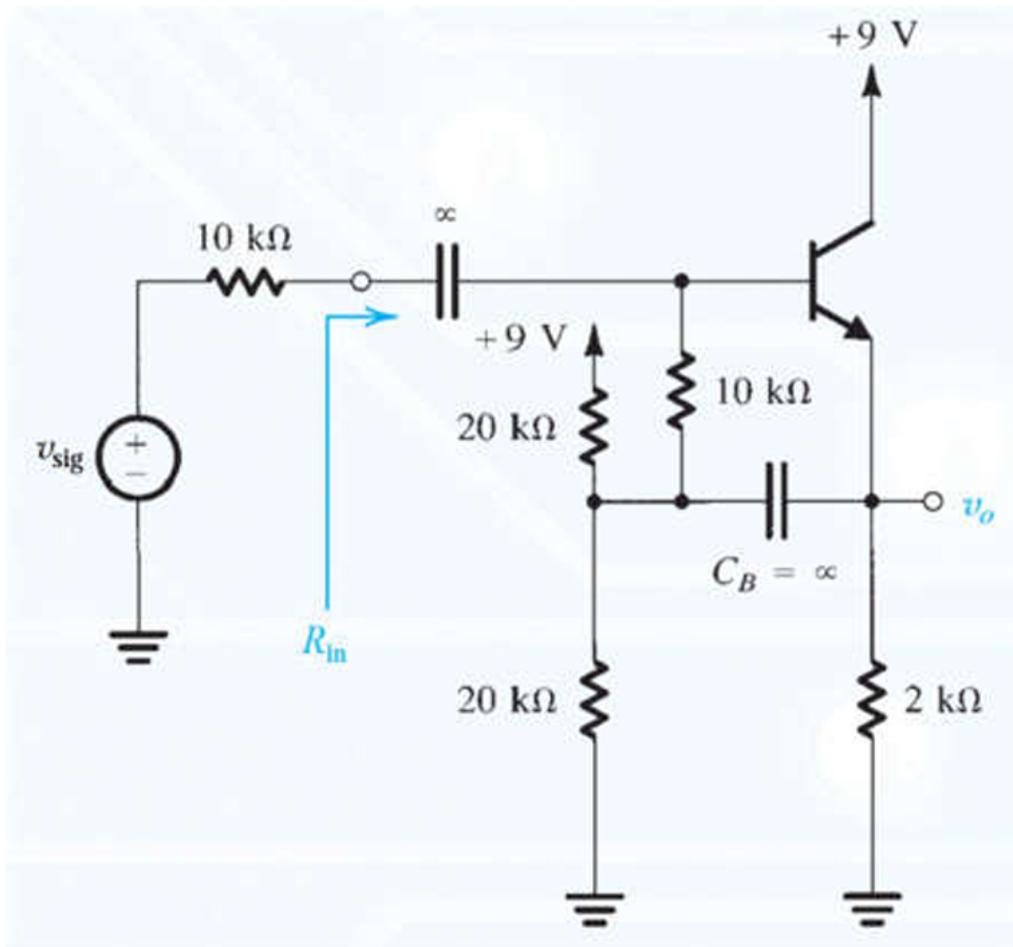
Ho Chi Minh, ..../..../20..

# Mục lục

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Câu 4</b>  | <b>1</b>  |
| a) . . . . .  | 1         |
| b) . . . . .  | 4         |
| c) . . . . .  | 9         |
| <b>Câu 5</b>  | <b>13</b> |
| a) . . . . .  | 13        |
| b) . . . . .  | 14        |
| c) . . . . .  | 17        |
| d) . . . . .  | 19        |
| <b>Câu 6</b>  | <b>20</b> |
| a) . . . . .  | 20        |
| b) . . . . .  | 23        |
| c) . . . . .  | 28        |
| <b>Câu 9</b>  | <b>31</b> |
| a) . . . . .  | 31        |
| b) . . . . .  | 34        |
| c) . . . . .  | 38        |
| d) . . . . .  | 40        |
| <b>Câu 10</b> | <b>43</b> |
| a) . . . . .  | 43        |
| b) . . . . .  | 47        |
| c) . . . . .  | 52        |

## Câu 4

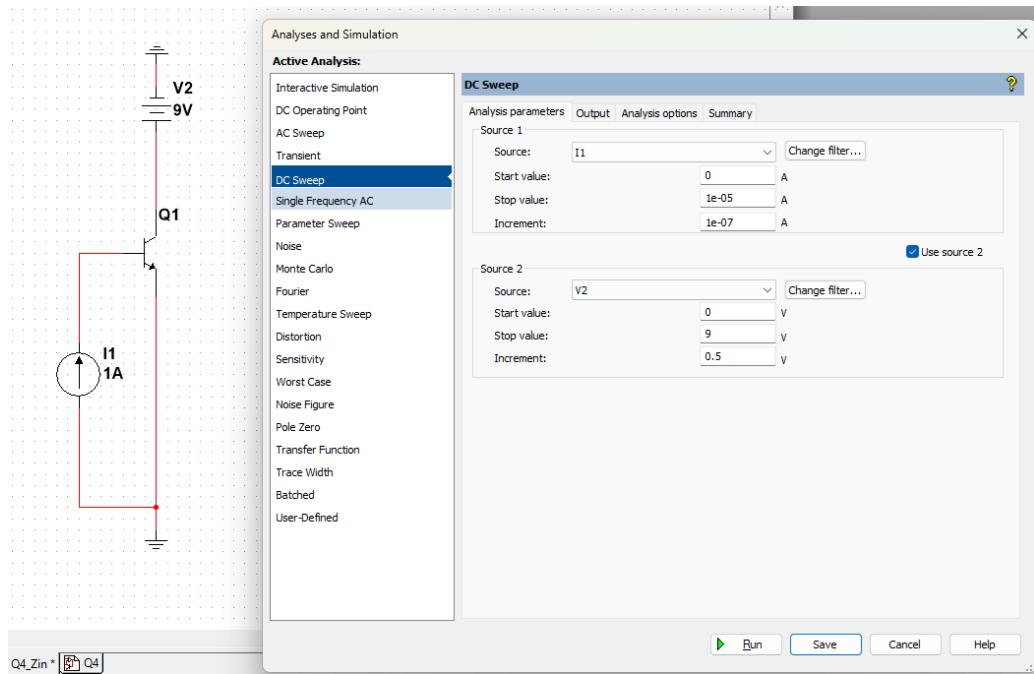
Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Giả sử các tụ có giá trị rất lớn. BJT có  $\beta = 100$  và  $V_A = \infty$ .



### a ) Tìm điểm hoạt động Q của BJT

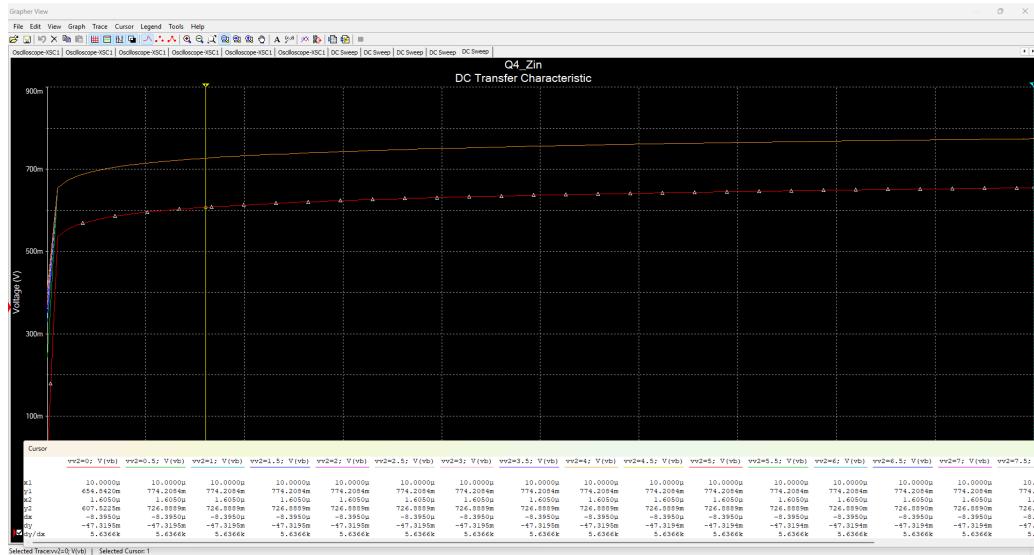
Xét hoạt động chế độ DC cho toàn mạch.

- Tìm giá trị  $V_{BE}$  của BJT trong Multisim



Hình 1: Tìm giá trị  $V_{BE}$  của mạch.

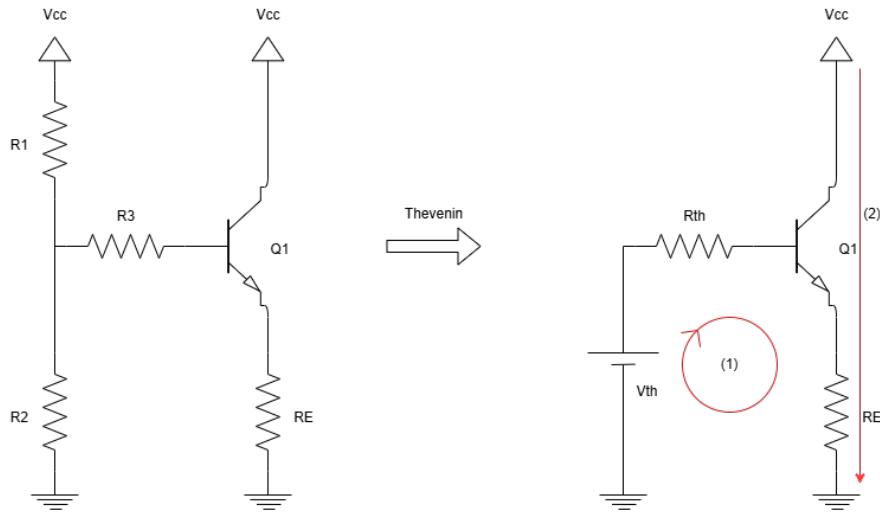
Ta sử dụng một chế độ DC Sweep để tìm giá trị  $V_{BE}$  dãy của mạch. Sau khi chạy tool ta có kết quả như sau,



Hình 2: Kết quả sau khi chạy DC Sweep để tìm  $V_{BE}$ .

Nhìn vậy hình ta thấy được điện áp  $V_{BE}$  của BJT dãy roi vào tầm  $\approx 0.774$  mA. Từ đó, nhóm em chọn  $V_{BE} = 0.774$  mA cho câu 4.

- Tìm giá trị  $I_{CQ}$



Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_3 + R_1//R_2 = 10 + \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 20k\Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} = \frac{20}{20 + 20} \times 9 = 4.5V$$

Áp dụng KCL cho vòng (1):

$$-V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

Ta có:  $I_E = (\beta + 1)I_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{4.5 - 0.774}{20 + (100 + 1) \times 2} = 0.0168 \text{ mA}$$

Ta có:  $I_C = \beta I_B = 100 \times 0.0168 \text{ mA} = 1.68 \text{ mA}$ .

- Tìm giá trị  $V_{CEQ}$

Áp dụng KCL cho vòng (2):

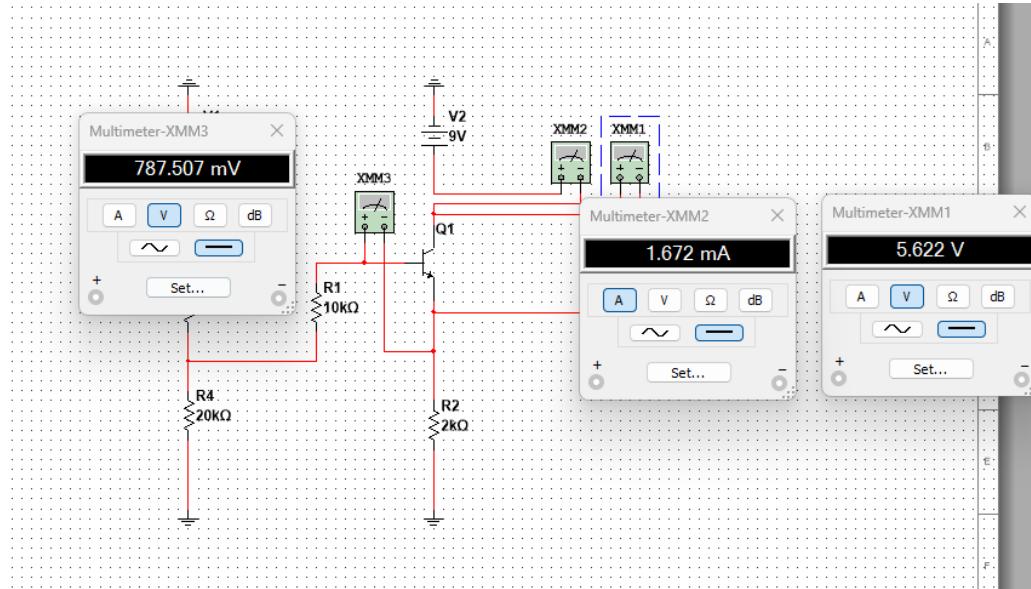
$$-V_{cc} + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

Ta có:  $I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = \alpha I_E \approx I_E$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{cc} - I_C R_E = 9 - 1.71 \times 2 = 5.64V$$

Vậy điểm làm việc Q của tần số 2 là :  $(I_{CQ}, V_{CEQ}) = (1.68 \text{ mA}, 5.64 \text{ V})$ .

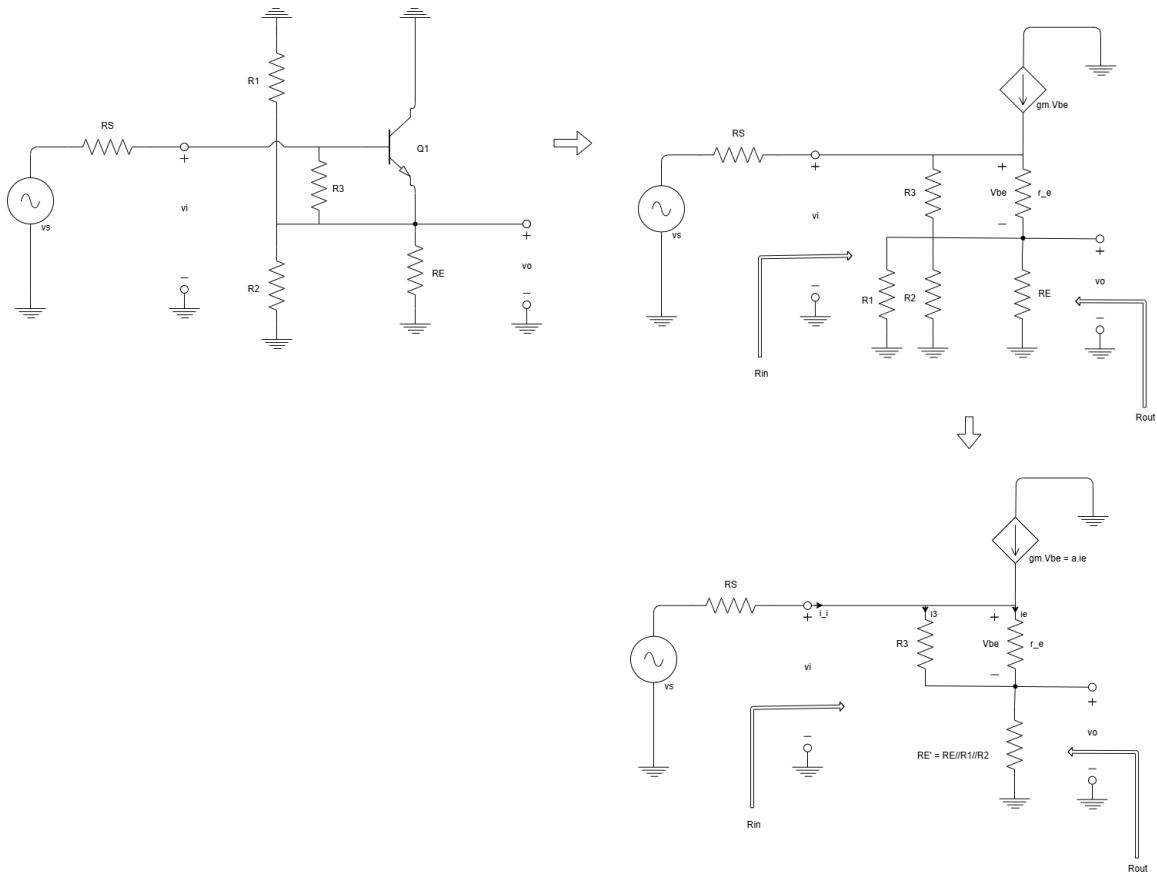
- Kiểm chứng kết quả:



Hình 3: Kết quả điểm Q của bài 4.

b ) **Đặt**  $v_s = V_s \sin(\omega t)$  **vào mạch.** **Ngõ ra nối với tải**  $R_L = 1k\Omega$ . **Tìm**  $A_{vo}$ ,  $G_v$ ,  $R_i$ ,  $R_o$  **của mạch.**

Xét hoạt động chế độ AC cho toàn mạch.



Ta có,

$$+ R'_E = R_E // R_1 // R_2 \approx 1.6667 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.68 \text{ m}}{25 \text{ m}} = 67.2 \text{ mS}$$

$$+ r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{I_C/\alpha} = \frac{25 \text{ mV}}{1.68 \text{ mA} / \frac{100}{100 + 1}} \approx 14.7336 \Omega$$

$$+ r_\pi = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \times \frac{25 \text{ m}}{1.68 \text{ m}} = 1.4881 \text{ k}\Omega$$

- Tính giá trị  $R_{in}$

Ta có,  $R_{in} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0}$ , đầu tiên ta xét

$$+ i_i = i_3 + i_e - \alpha i_e$$

$$\text{Trong đó, } i_3 = \frac{i_e r_e}{R_3}$$

$$\Rightarrow i_i = \frac{i_e r_e}{R_3} + i_e(1 - \alpha)$$

$$+ v_i = v_{be} + v_o$$

$$\text{Trong đó, } v_o = R'_E(i_3 + i_e) = R'_E \left( \frac{i_e r_e}{R_3} + i_e \right)$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{R'_E \left( \frac{i_e r_e}{R_3} + i_e \right) + i_e r_e}{\frac{i_e r_e}{R_3} + i_e (1 - \alpha)} = \frac{R'_E \left( \frac{r_e}{R_3} + 1 \right) + r_e}{\frac{r_e}{R_3} + (1 - \alpha)} \approx 148.0428 \text{ k}\Omega.$$

$$\Rightarrow R_{in} = 148.0428 \text{ k}\Omega.$$

- Tính giá trị  $R_{out}$

$$\text{Ta có, } R_{out} = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_i=0}$$

$$\Rightarrow R_{out} = R'_E // r_e // \frac{R_3}{\beta + 1} = 12.7272 \Omega.$$

$$\Rightarrow R_{out} = 12.7272 \Omega.$$

- Tính giá trị  $A_{vo}$

$$\text{Ta có, } A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} \Big|_{R_L=\infty} = \frac{R'_E \left( \frac{r_e}{R_3} + 1 \right)}{R'_E \left( \frac{r_e}{R_3} + 1 \right) + r_e} \approx 0.9913 \text{ V/V.}$$

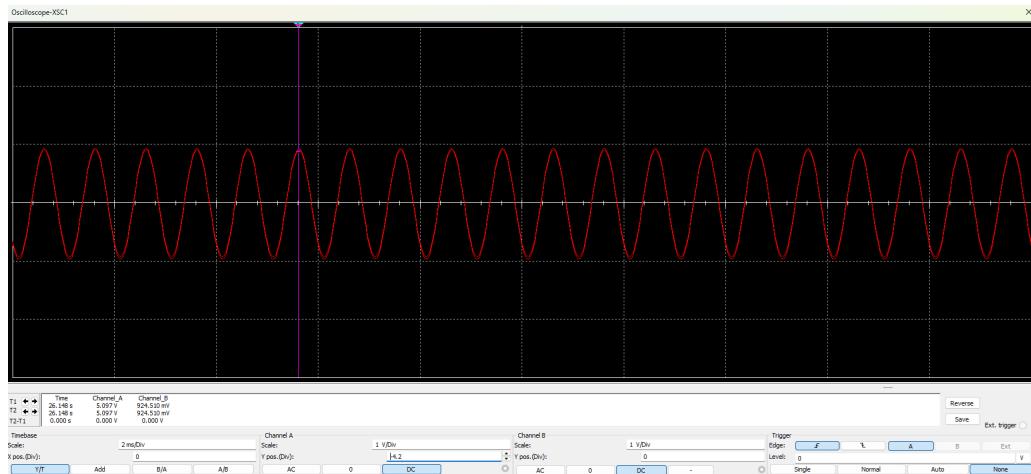
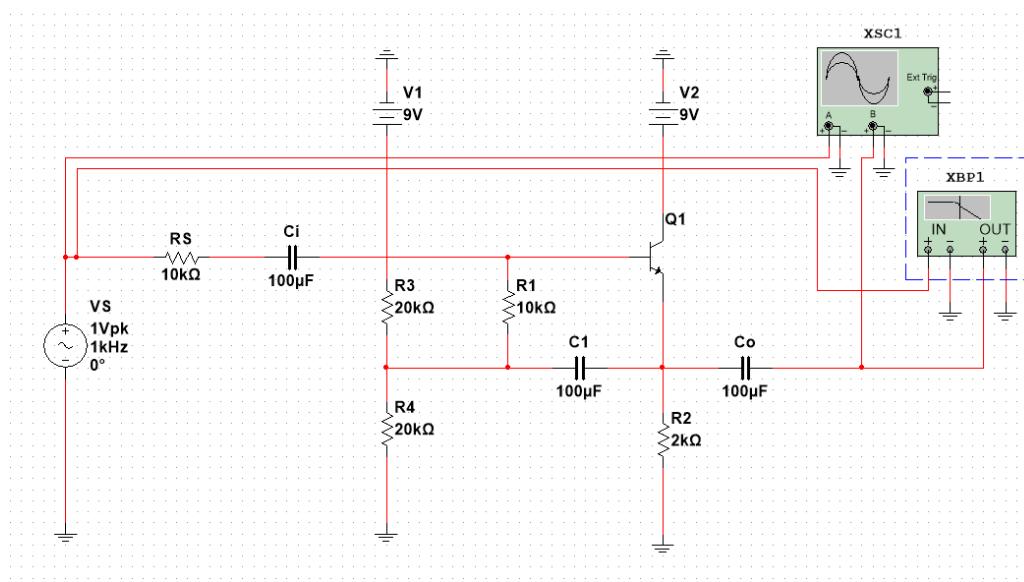
$$\Rightarrow A_{vo} = 0.9913 \text{ V/V.}$$

- Tính giá trị  $G_v$

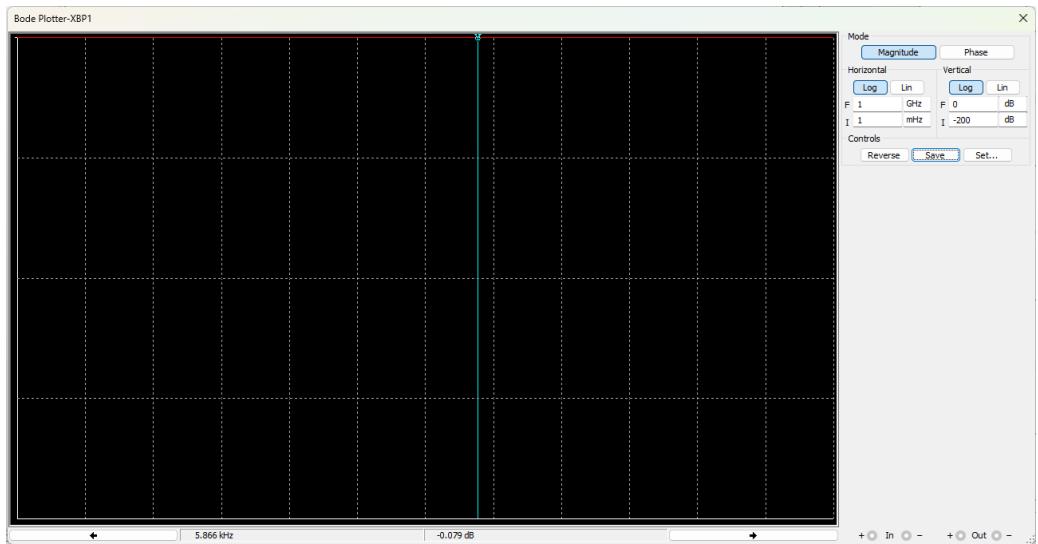
$$\text{ta có, } G_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} A_v = \frac{148.0428}{148.0428 + 10} \times 0.9914 \approx 0.9287 \text{ V/V.}$$

$$\Rightarrow G_v = 0.9287 \text{ V/V.}$$

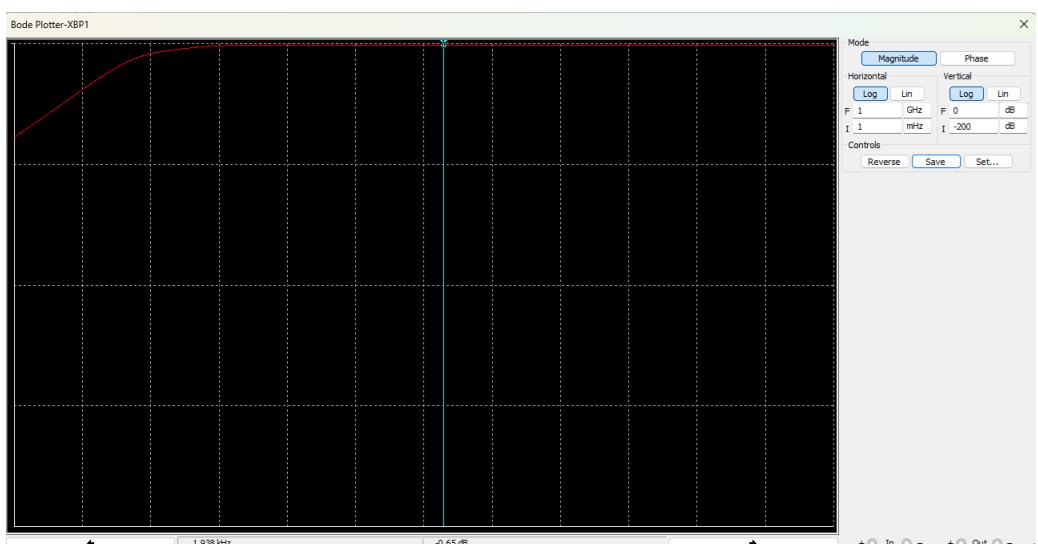
- Kiểm tra kết quả



Hình 4: Coi dạng sóng ngõ vào và ngõ ra của mạch.

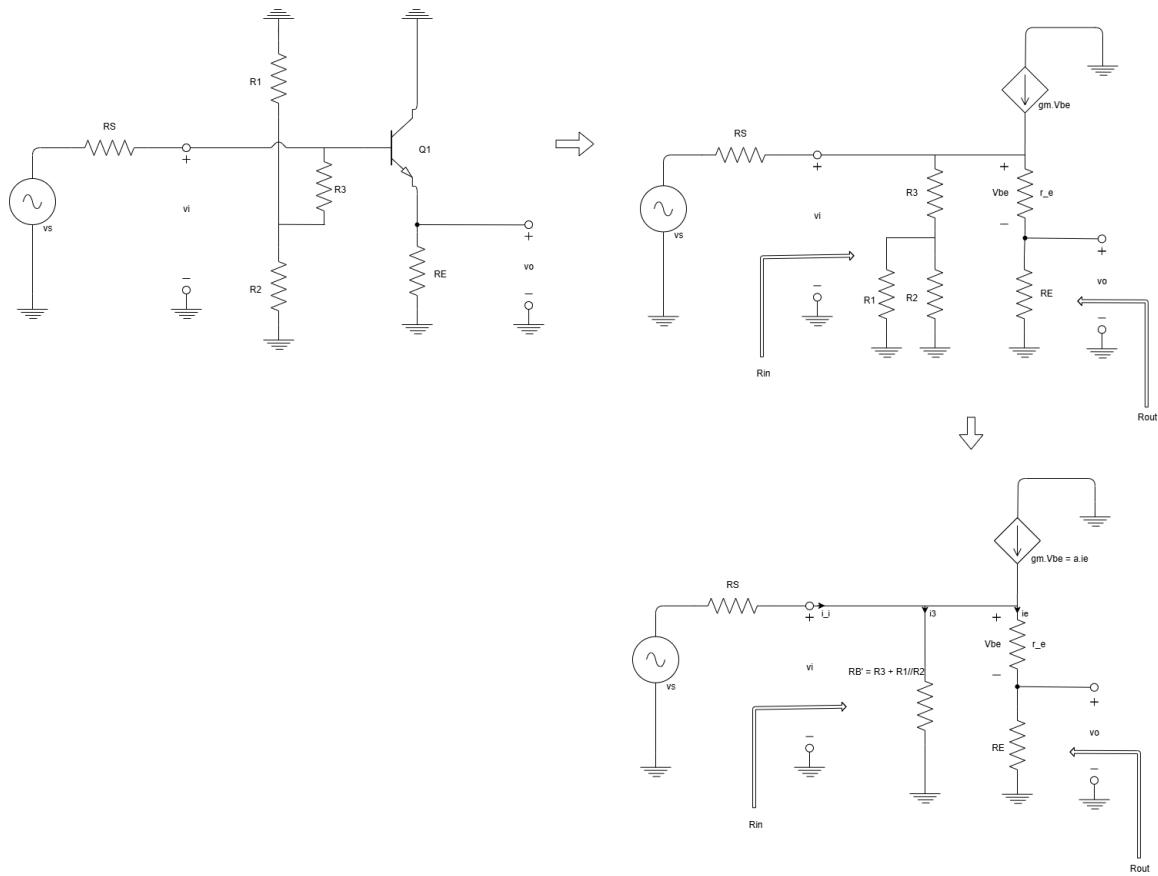


Hình 5: Tiến hành đo  $A_{vo} = -0.079dB \approx 0.9909$ .



Hình 6: Tiến hành đo  $G_v = -0.65dB \approx 0.9279$ .

c ) Bỏ tụ  $C_B$  ra khỏi mạch. Lập lại câu a và b. Từ đó, nêu vai trò của tụ  $C_B$ .



Ta có,

$$\begin{aligned}
 &+ R'_B = R_3 + R_1 // R_2 = 20 \text{ k}\Omega \\
 &+ g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.68 \text{ m}}{25 \text{ m}} = 67.2 \text{ mS} \\
 &+ r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{I_C/\alpha} = \frac{25 \text{ mV}}{1.68 \text{ mA} / \frac{100}{100+1}} \approx 14.7336 \Omega \\
 &+ r_\pi = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \times \frac{25 \text{ m}}{1.68 \text{ m}} = 1.4881 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

- Tính giá trị  $R_{in}$

$$\text{Ta có, } R_{in} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0}$$

$$\rightarrow R_{in} = R'_B // (\beta + 1)(r_e + R_E) \approx 18.2102 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{in} = 18.2102 \text{ k}\Omega.$$

- Tính giá trị  $R_{out}$

$$\text{Ta có, } R_{out} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0}$$

$$\rightarrow R_{out} = R_E // r_e = 14.6259 \Omega$$

$$\Rightarrow R_{out} = 14.6259 \Omega.$$

- Tính giá trị  $A_{vo}$

$$\text{Ta có, } A_{vo} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = \frac{R_E}{R_E + r_e} \approx 0.9927 \text{ V/V.}$$

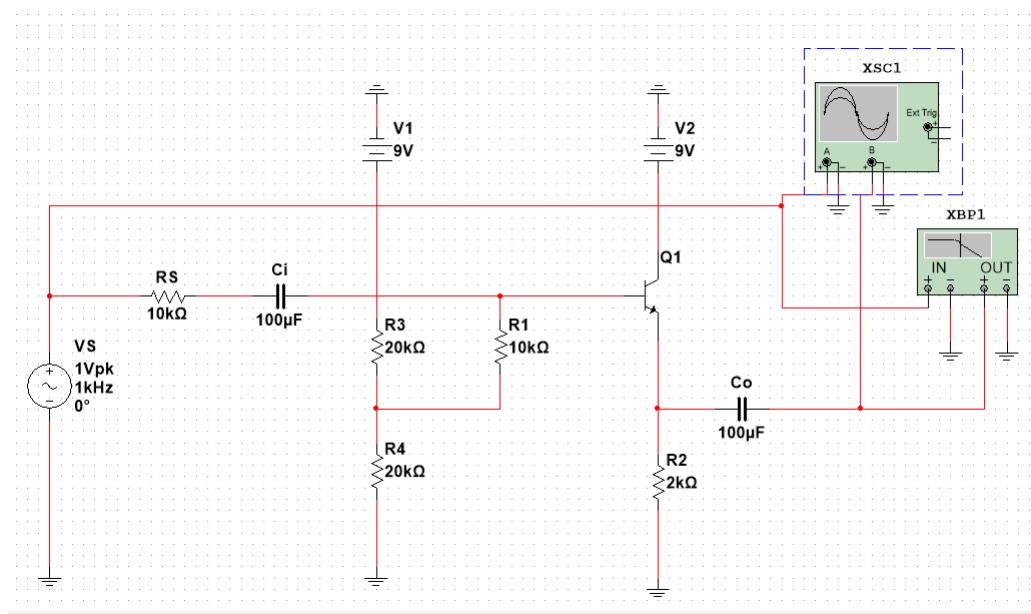
$$\Rightarrow A_{vo} \approx 0.9927 \text{ V/V}.$$

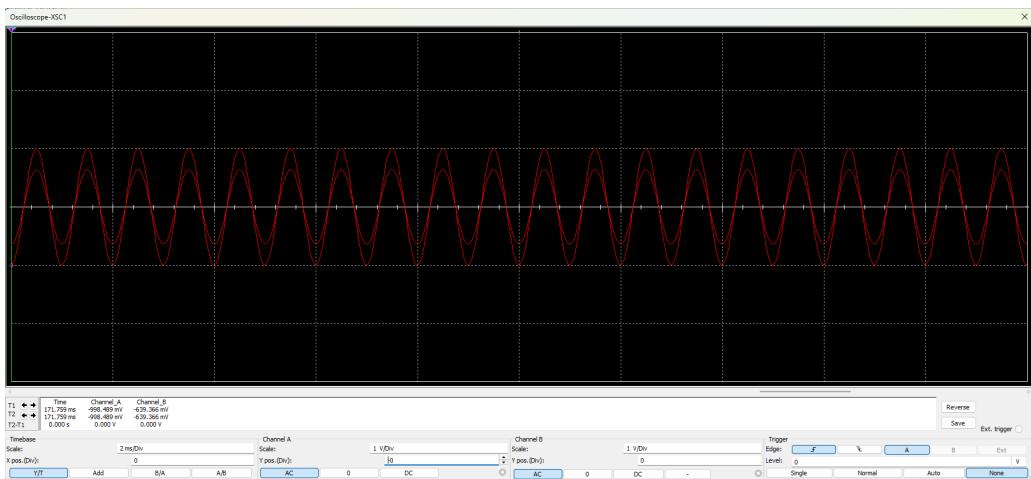
- Tính giá trị  $G_v$

$$\text{ta có, } G_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} A_v = \frac{18.2102}{18.2102 + 10} \times 0.9927 \approx 0.6408 \text{ V/V.}$$

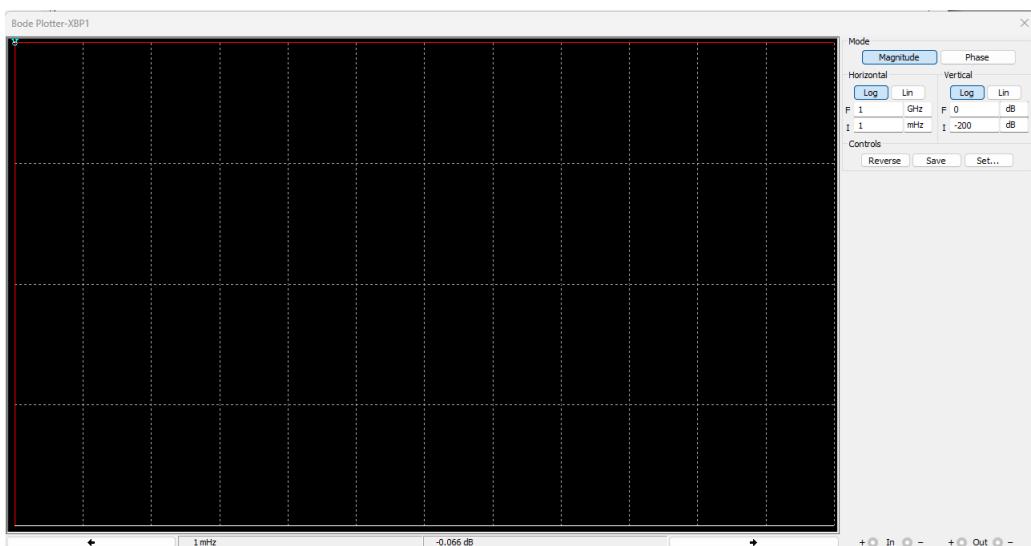
$$\Rightarrow G_v = 0.6408 \text{ V/V}.$$

- Kiểm tra kết quả

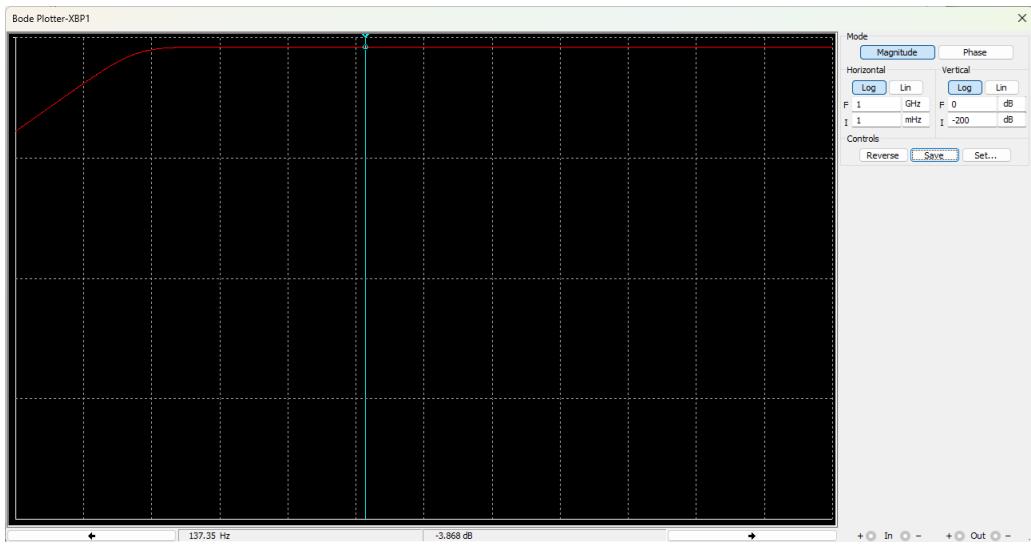




Hình 7: Coi dạng sóng ngõ vào và ngõ ra của mạch.



Hình 8: Tiến hành đo  $A_{vo} = -0.066dB \approx 0.9924$ .



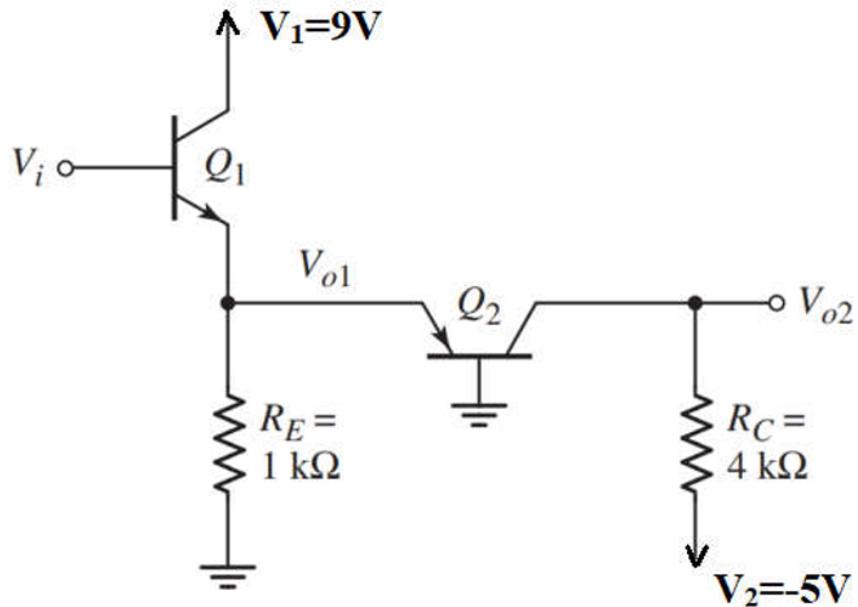
Hình 9: Tiến hành đo  $G_v = -3.868dB \approx 0.6406$ .

## Nhận xét

Mạch trên giống với mạch Bootstrapped Emitter Follower với có một tụ  $C_B$  hồi tiếp dương qua tụ, mạch giúp tăng điện trở đầu vào giúp tăng độ lợi của mạch mà không cần tăng điện trở lên quá cao. Với một chỉ cần hồi tiếp về kết hợp một điện trở  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$  đã có thể tăng  $R_{in}$  từ  $18.2102\text{ k}\Omega \rightarrow 148.0428\text{ k}\Omega$  có nghĩa là tăng lên đến 8, và tăng độ lợi  $G_v$  từ  $0.6408 \rightarrow 0.9287$ .

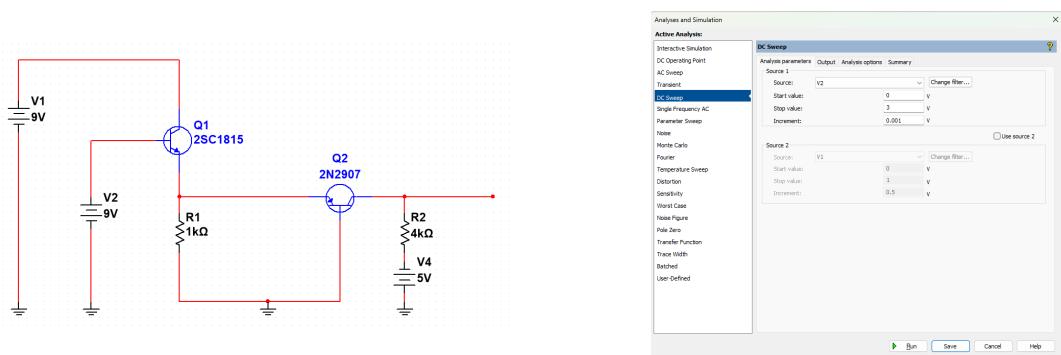
## Câu 5

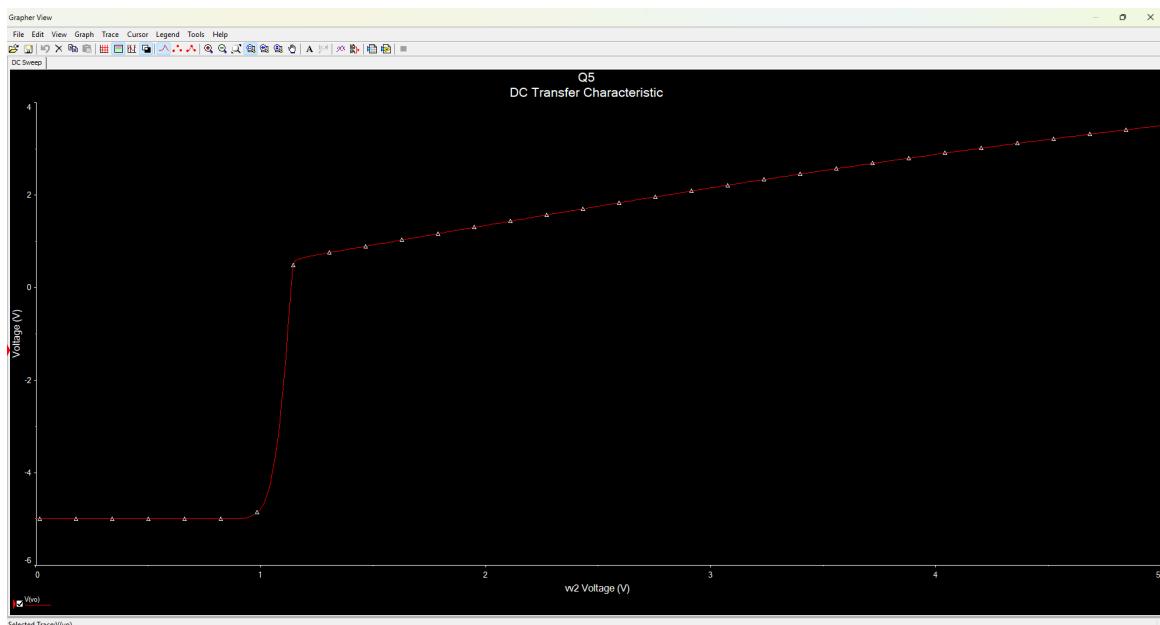
Cho mạch khuếch đại tín hiệu được ghép liên tầng như hình vẽ. Trong đó,  $Q_1$  là BJT có  $\beta = 100$  và mã 2SC1815, và  $Q_2$  có  $\beta = 80$  có mã là 2N2907.



a ) Sử dụng phần mềm mô phỏng, vẽ VTC của mạch (ngõ vào  $V_i$  và ngõ ra là  $V_o$ ).

Sử dụng chế độ DC Sweep trong Multisim để khảo sát VTC,

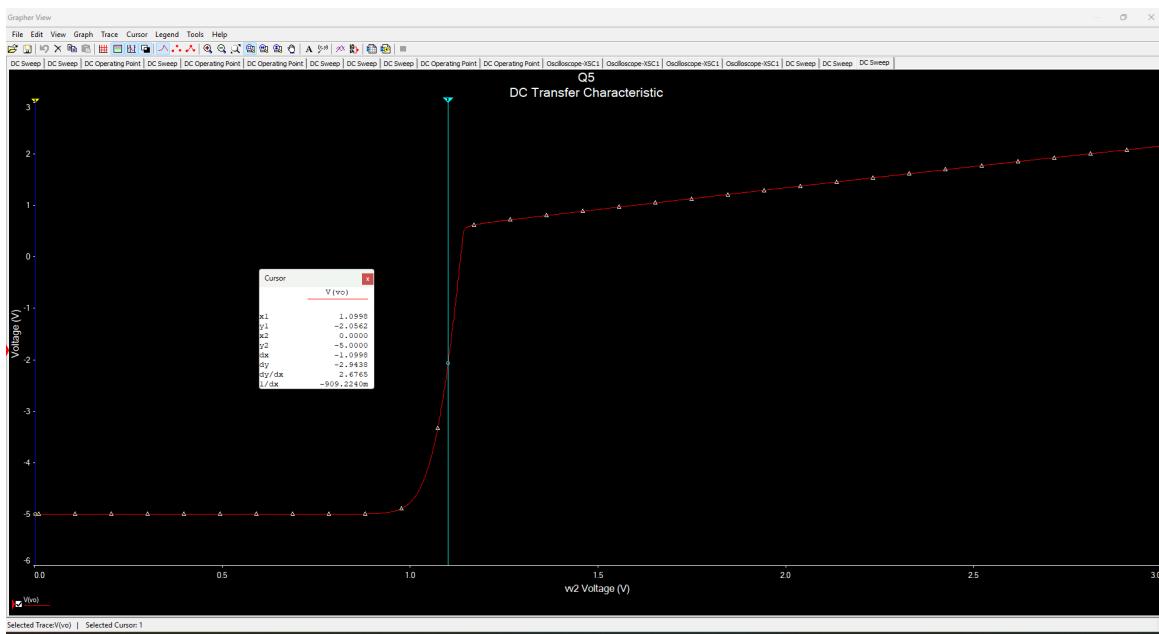




Hình 10: VTC của mạch với ngõ vào  $V_i$  và ngõ ra là  $V_o$ .

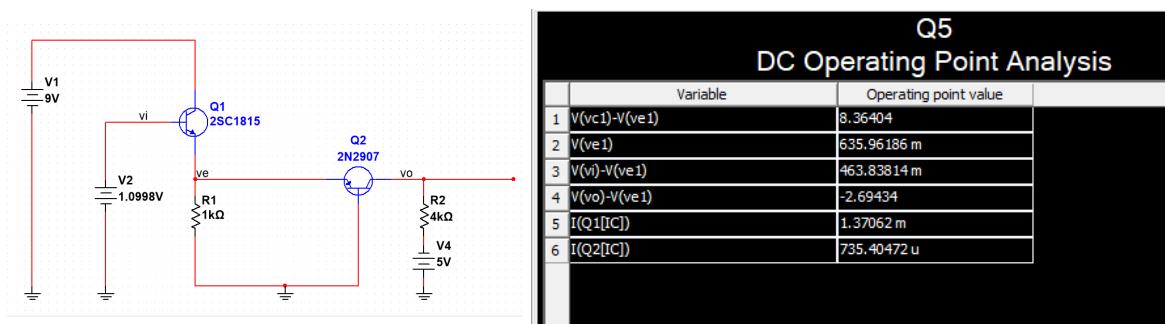
**b ) Lựa chọn điểm phân cực của cả mạch trên VTC và thiết kế mạch ghép vào phía trước VTC để có được điểm phân cực đó.**

Quan sát VTC của mạch, để tín hiệu ngõ ra không bị méo dạng thì ta chọn điểm  $Q$  với  $V_i = 1.0998 \text{ V}$ .



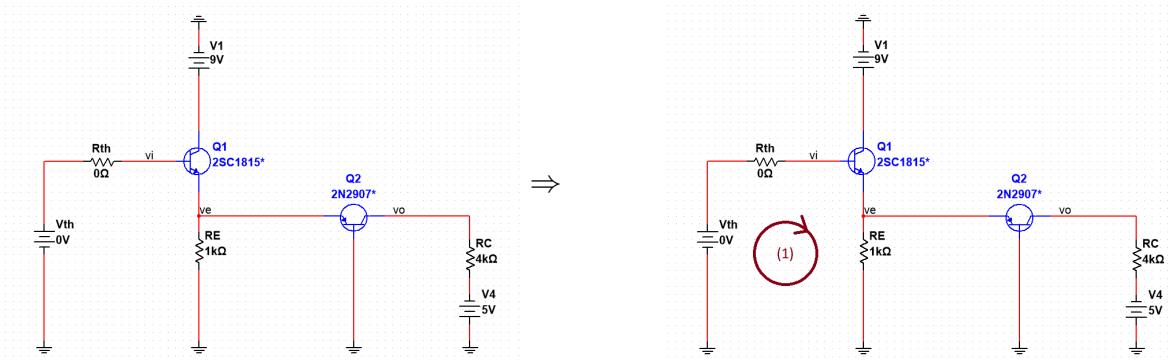
Hình 11: Điểm hoạt động của toàn mạch rơi vào tầm  $V_i = 1.0998$  V để tín hiệu  $V_o$  không méo dang.

Với  $V_i = 1.0998$  V, ta chọn được hai điểm:



- $Q_1 = (I_{CQ1}, V_{CEQ1}) = (1.3706 \text{ mA}, 8.3640 \text{ V})$
- $Q_2 = (I_{CQ2}, V_{CEQ2}) = (0.7354 \text{ mA}, -2.6943 \text{ V})$

Ta sử dụng một mạch phân cực  $R_1$  và  $R_2$  như sau:



$$\text{Ta có, } I_{C1} = 1.3706 \text{ mA} \Rightarrow I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{1.3706}{100} = 0.013706 \text{ mA.}$$

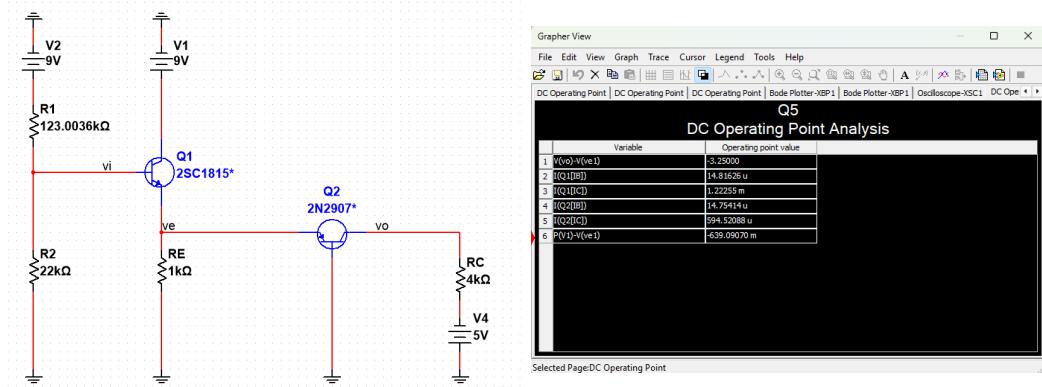
$$I_{RE} = I_{E1} - I_{E2} = \frac{I_{C1}}{\alpha} - \frac{I_{C2}}{\alpha} = \frac{1.3706}{100} - \frac{0.7354}{100+1} = 0.64582 \text{ mA}$$

Viết KCL cho vòng (1):

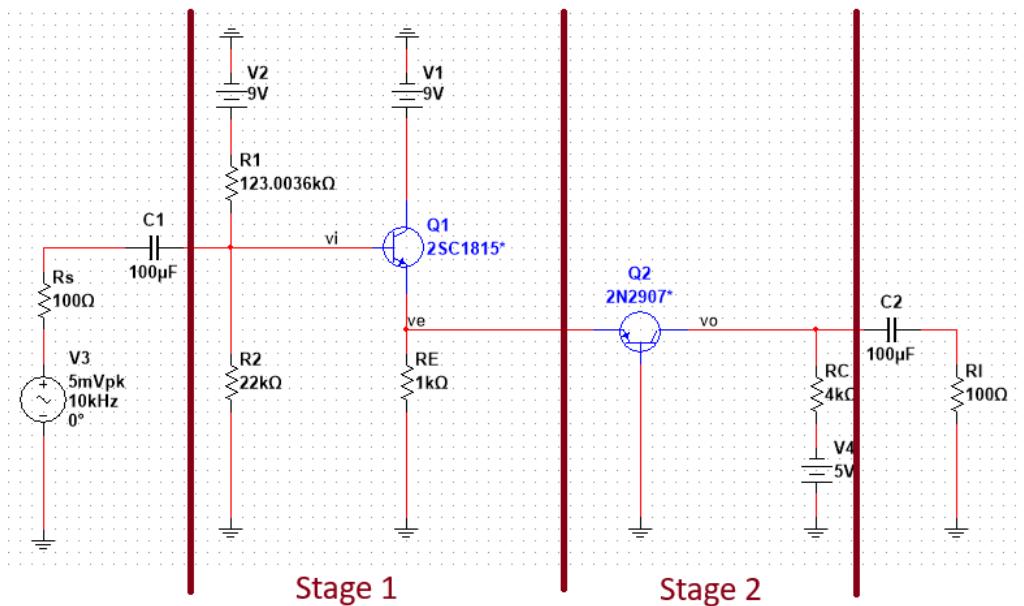
$$\begin{aligned} V_{th} &= R_{th}I_{B1} + V_{BE1} + I_{RE}R_E \\ \Leftrightarrow 9 &\times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} \times I_{B1} + V_{BE1} + R_EI_{RE} \\ \Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} (9 - R_1 &\times 0.013706) = 1.1097 \end{aligned}$$

Với chọn \$R\_2 = 22 k\Omega \Rightarrow R\_1 = 123.0036 k\Omega\$.

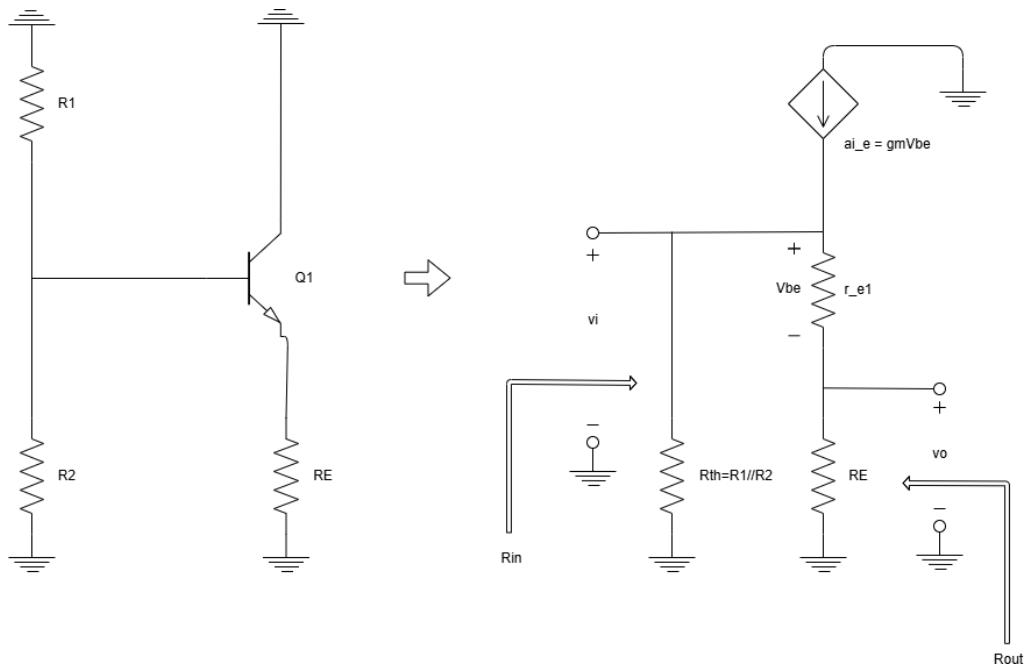
Kết quả mô phỏng,



c ) Lựa chọn tụ  $C_1$  (ghép tín hiệu) và  $C_2$  (ghép tải) để mạch có  $f_L = 200Hz$ . Giả sử tín hiệu có nội trở  $100\Omega$  và tải có điện trở  $100\Omega$ . Sử dụng phần mềm mô phỏng, vẽ đáp ứng tần số của mạch.



- Với tầng 1



$$+ r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = 18.0560 \Omega$$

$$+ r_{\pi 1} = \beta \frac{V_T}{I_{C1}} = 1.8240 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 54.824 \text{ mS}$$

Tính  $R_{in1} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_{th}/(\beta + 1)(r_{e1} + R_E)$

$$\Rightarrow R_{in1} = 15.7954 \text{ k}\Omega$$

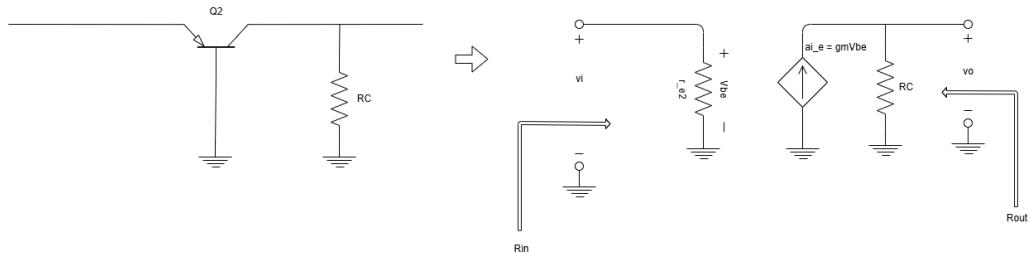
Tính  $R_{out1} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = r_{e1}/R_E$

$$\Rightarrow R_{out1} = 17.7358 \Omega$$

Tín  $A_{vo1} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = \frac{R_E}{R_E + r_{e1}}$

$$\Rightarrow A_{vo1} = 0.9823 \text{ V/V}$$

- Với tầng 2



$$+ r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E2}} = 33.6585 \Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \beta \frac{V_T}{I_{C2}} = 2.7196 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 29.416 \text{ mS}$$

Tính  $R_{in2} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = r_{e2}$

$$\Rightarrow R_{in2} = 33.6585 \Omega$$

Tính  $R_{out2} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = R_C$

$$\Rightarrow R_{out2} = 4 \text{ k}\Omega$$

Tín  $A_{vo2} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = -g_{m2}R_C$

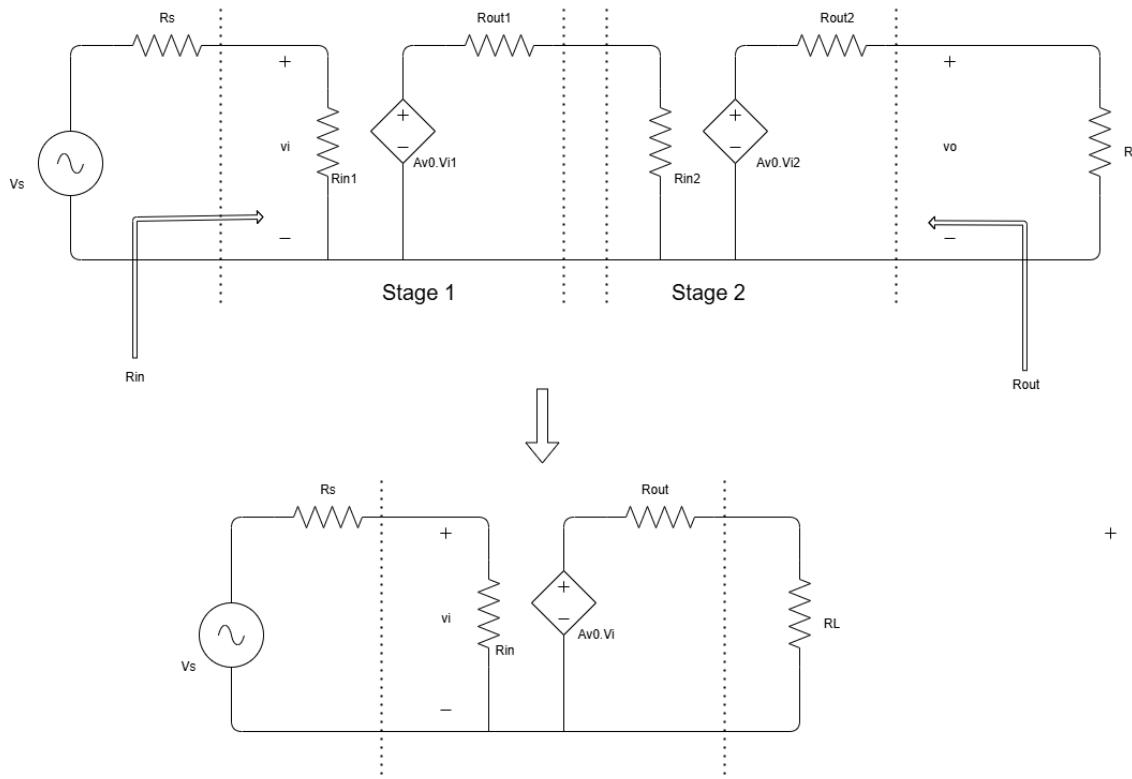
$$\Rightarrow A_{vo2} = 117.664 \text{ V/V}$$

Lựa chọn  $C_1$  và  $C_2$  để  $f_L = 200 \text{ Hz}$

$$- f_{C_1} = \frac{1}{2\pi\omega_1 C_1 (R_{in1} + R_s)} = 200\text{Hz}$$

$$\Rightarrow C_1 =$$

d ) Đặt vào mạch tín hiệu xoay chiều có biên độ 5mV và tần số 10KHz. Sử dụng phần mềm mô phỏng, cho biết tín hiệu tại  $V_{o1}$  và  $V_{o2}$ .  
Giải thích



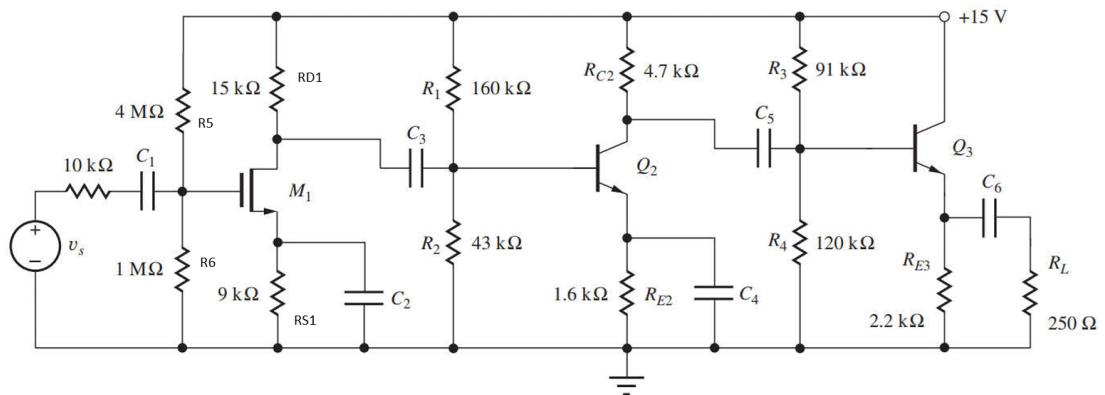
$$+ A_{vo} = A_{vo2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} A_{vo1} = 75.6951 \text{ V/V}$$

$$+ A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out2}} = 1.8462 \text{ V/V}$$

$$+ G_v = \frac{R_s}{R_s + R_{in1}} A_v = 1.8346 \text{ V/V} \approx 5.2708 \text{ dB}$$

## Câu 6

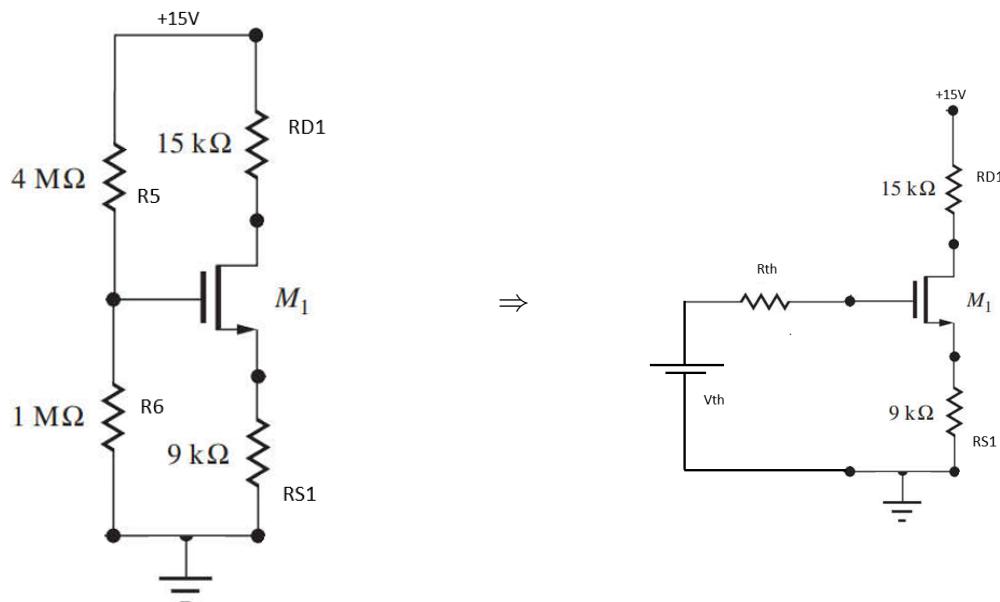
Cho mạch khuếch đại tín hiệu được ghép liên tầng như hình vẽ. Giả sử các tụ có điện dung rất lớn. Các thông số  $\beta = 100$ ,  $K_n = 1mA/V^2$ ,  $V_{TN} = 1V$ . BJT có  $V_A = \infty$  và FET có  $\lambda = 0$ .



### a ) Tìm các điểm hoạt động của Q

Xét hoạt động chế độ DC cho toàn mạch.

- Tầng 1:



Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_5 // R_6 = \frac{4M \times 1M}{4M + 1M} = 0.8M \Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times V_{cc} = \frac{1M}{1M + 4M} \times 15 = 3V$$

$$\Rightarrow V_G = 3V \Rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = 3 - V_S$$

$$\text{Với } V_S = I_{DS} \times R_{S1} \Rightarrow V_{GS} = 3 - I_{DS} \times R_{S1}$$

$$\begin{aligned} I_{DS1} &= \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_{tn})^2 \\ &= \frac{1}{2} K_n (3 - I_{DS} \times R_{S1} - V_{tn})^2 \\ &= \frac{1}{2} (3 - I_{DS} \times 9 - 1)^2 \end{aligned}$$

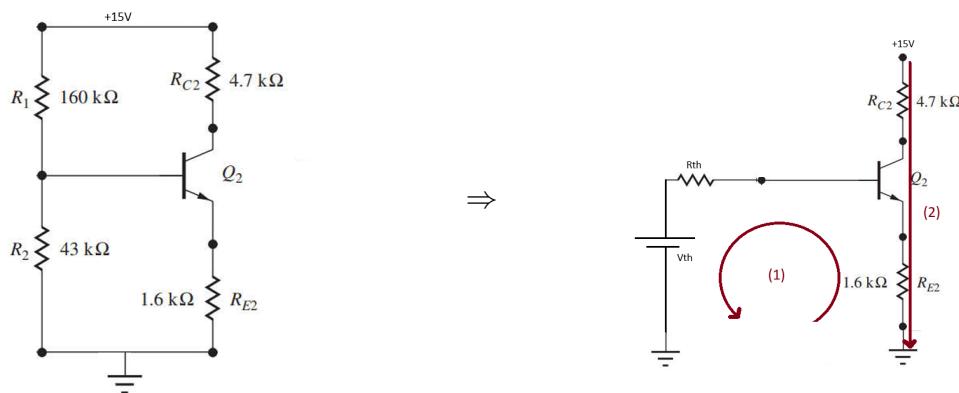
$$\Rightarrow \begin{cases} I_{DS1} = 0.3097mA \rightarrow V_{GS} = 3 - 0.3097 \times 9 = 0.2127V < V_{tn} (\text{Loại}) \\ I_{DS1} = 0.1595mA \rightarrow V_{GS} = 3 - 0.1595 \times 9 = 1.5645V > V_{tn} (\text{Thỏa}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_D = V_{cc} - I_D \times R_{D1} = 15 - 0.1595 \times 15 = 12.6075V$$

$$\Rightarrow V_{DS1} = V_D - V_S = 11.1720V$$

Vậy điểm làm việc Q của tầng 1 là :  $(I_{DS1}, V_{DS1}) = (0.1595mA, 11.1720V)$ .

- Tầng 2:



Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_1 // R_2 = \frac{160k \times 43k}{160k + 43k} \approx 33.8916k \Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{cc} = \frac{43k}{160k + 43k} \times 15 \approx 3.1773V$$

Áp dụng KVL cho vòng (1):

$$-I_{E2} \times R_{E2} - V_{BE} - I_{B2} \times R_{th} + V_{th} = 0$$

Ta có:  $I_{E2} = (\beta + 1)I_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_{E2}} = \frac{3.1773 - 0.7}{33.8916 + (100 + 1)1.6} = 0.0127mA$$

Ta có:  $I_{C2} = \beta I_{B2} = 100 \times 0.0127mA = 1.270mA$ .

Áp dụng KVL cho vòng (2):

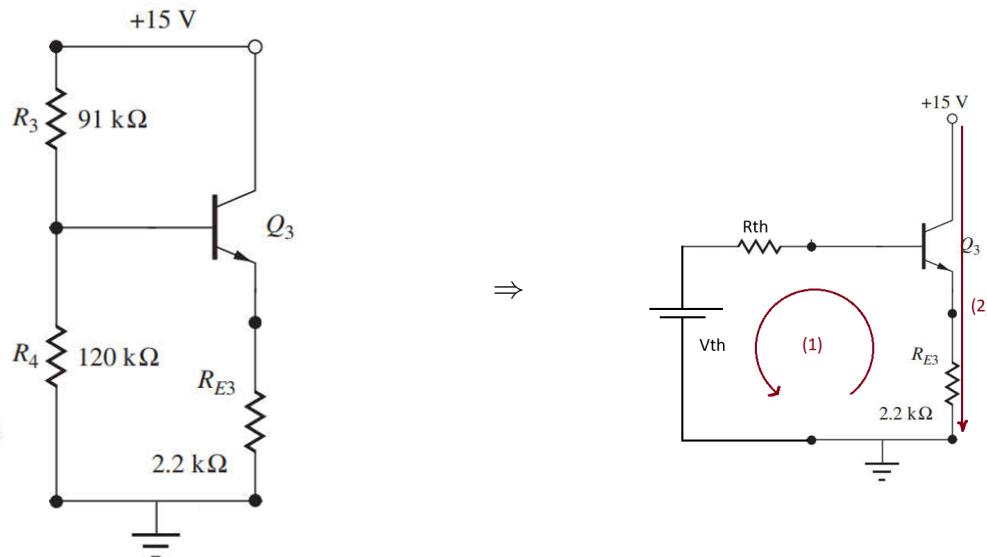
$$-V_{cc} + I_{C2}R_{C2} + V_{CE} + I_{E2}R_{E2} = 0$$

Ta có:  $I_{C2} = \frac{\beta}{\beta + 1}I_{E2} = \alpha I_{E2} \approx I_{E2}$

$$\Rightarrow V_{CE2} = V_{cc} - I_{C2}(R_{C2} + R_{E2}) = 15 - 1.270(4.7 + 1.6) = 6.9990V$$

Vậy điểm làm việc Q của tầng 2 là :  $(I_{CQ2}, V_{CEQ2}) = (1.270mA, 6.9990V)$ .

- Tầng 3:



Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_3 // R_4 = \frac{91k \times 120k}{91k + 120k} \approx 51.7536k\Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times V_{cc} = \frac{120k}{91k + 120k} \times 15 \approx 8.5308V$$

Áp dụng KVL cho vòng (1):

$$-I_{E3} \times R_{E3} - V_{BE} - I_{B3} \times R_{th} + V_{th} = 0$$

Ta có:  $I_{E3} = (\beta + 1)I_{B3}$

$$\Rightarrow I_{B3} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_{E3}} = \frac{8.5308 - 0.7}{51.7536 + (100 + 1)2.2} = 0.0286mA$$

Ta có:  $I_{C3} = \beta I_{B3} = 100 \times 0.0286mA = 2.86mA$ .

Áp dụng KVL cho vòng (2):

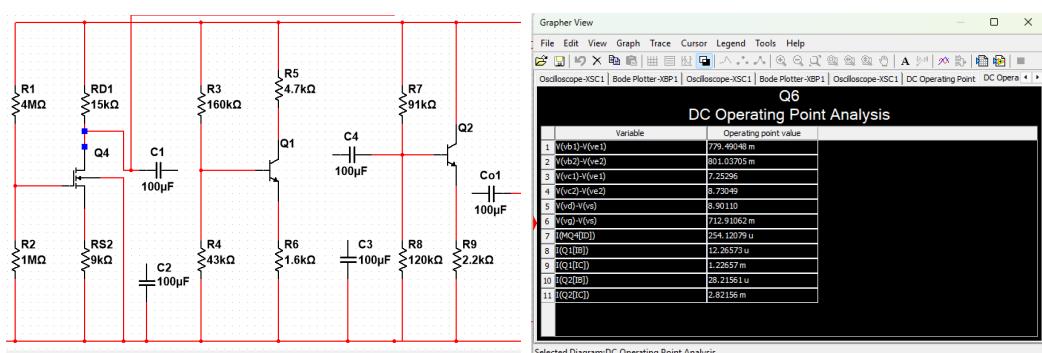
$$-V_{cc} + V_{CE} + I_E R_{E2} = 0$$

Ta có:  $I_{C3} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E3} = \alpha I_{E3} \approx I_E$

$$\Rightarrow V_{CE3} = V_{cc} + R_{E2} I_{E3} = 15 - 2.86(2.2) = 8.708V$$

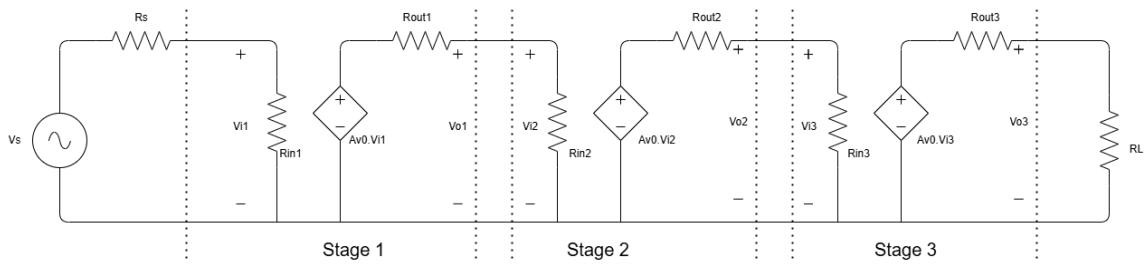
Vậy điểm làm việc Q của tần số 3 là : (I<sub>CQ3</sub>, V<sub>CEQ3</sub>) = (2.86mA, 8.708V).

Kiểm chứng kết quả

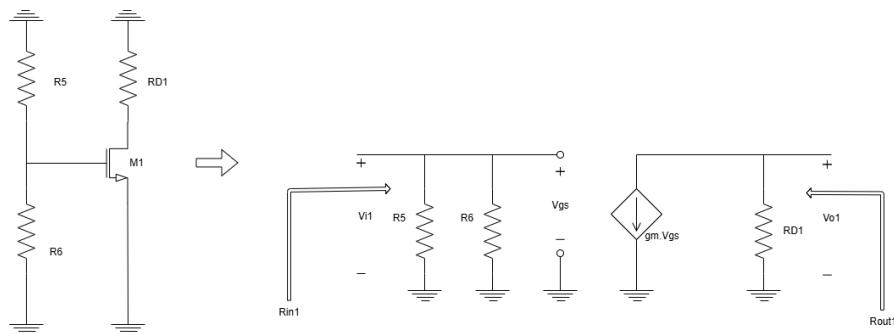


b ) Tìm  $A_v$ ,  $G_v$ ,  $R_i$ ,  $R_o$  của mạch.

Xét hoạt động chế độ AC cho toàn mạch, ta có mạch tương đương như sau:



- Tầng 1:



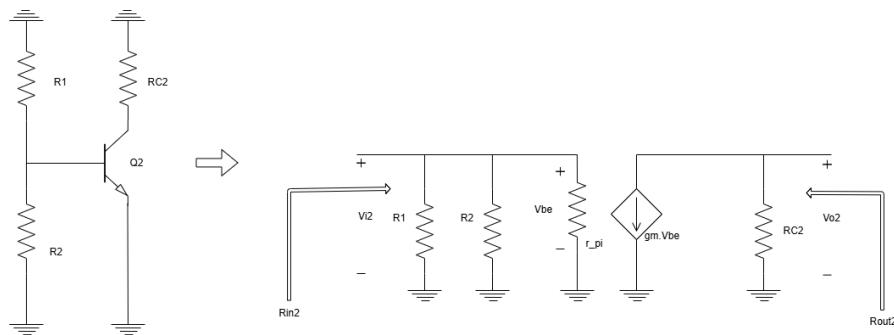
$$+ R_{in1} = \frac{v_i}{i_i}|_{v_o=0} = R_5 // R_6 = \frac{4M \times 1M}{4M + 1M} = 0.8M \Omega$$

$$+ R_{out1} = \frac{v_o}{i_o}|_{i_i=0} = R_{D1} = 15k \Omega$$

$$+ A_{vo1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}}|_{R_L=\infty} = \frac{v_{o1}}{V_{gs}} = -g_m R_{D1}$$

$$\begin{aligned} & \text{Trong đó, } g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{OV}} = \frac{2I_{DQ}}{V_{GS} - V_{tn}} = \frac{2 \times 0.1595mA}{1.5645V - 1V} \approx 0.5651mA/V \\ & \Rightarrow A_{vo1} = -0.5651mA/V \times 15k = -8.4765V/V. \end{aligned}$$

- Tầng 2:



$$+ R_{in2} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_1 // R_2 // r_\pi$$

$$\begin{aligned} & \text{Trong đó, } r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \frac{25mV}{1.270mA} = 1.9685k \Omega \\ & \Rightarrow R_{in2} = 1.8604k \Omega \end{aligned}$$

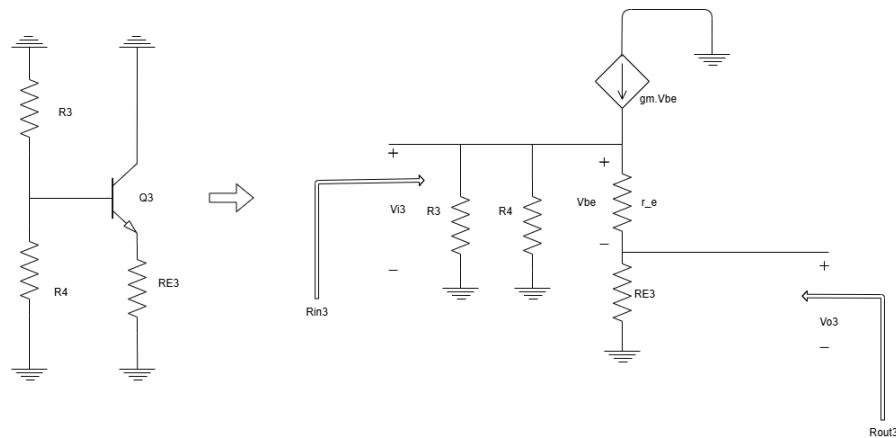
$$+ R_{out2} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = R_{C2} = 4.7k\Omega$$

$$+ A_{vo_2} = \frac{v_{o2}}{v_{i2}}|_{R_L=\infty} = \frac{v_{o2}}{v_{be}} = -g_m R_{C2}$$

$$\text{Trong đó, } g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.270mA}{25mV} = 0.0508A/V$$

$$\Rightarrow A_{vo_2} = -0.0508 \times 4.7k = -238.76V/V.$$

- Tầng 3:



$$+ R_{in3} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_3//R_4//((\beta + 1)(r_e + R_{E3}))$$

$$\text{Trong đó, } r_e = \alpha \frac{V_T}{I_C} = \frac{\beta}{\beta + 1} \frac{V_T}{I_C} = \frac{100}{100 + 1} \frac{25mV}{12.86mA} = 8.6547\Omega$$

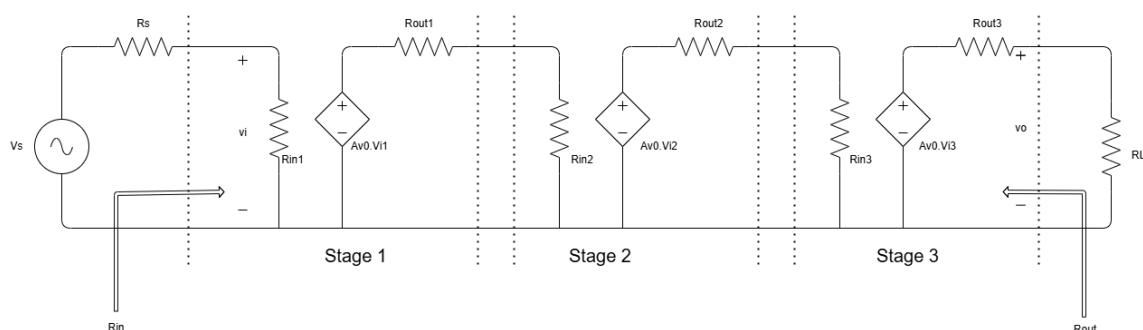
$$\Rightarrow R_{in3} = 42.0078k\Omega$$

$$+ R_{out3} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = (r_e//R_{E3}) = 8.6208\Omega$$

$$+ A_{vo_3} = \frac{v_{o3}}{v_{i3}}|_{R_L=\infty} = \frac{R_{E3}}{r_e + R_{E3}} = 0.9961V/V$$

$$\Rightarrow A_{vo_3} = 0.9961V/V.$$

Cuối cùng ta có mạch tương đương như sau:



-  $R_{in} = R_{in1} = 0.8M\Omega$

-  $R_{out} = R_{out3} = 8.6208\Omega$

$$\begin{aligned} - A_{vo} &= \frac{v_o}{v_i} \Big|_{R_L=\infty} \\ &= A_{vo_3} \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{out2}} A_{vo_2} \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} A_{vo_1} \\ &= 200.0600 V/V \end{aligned}$$

$\Rightarrow A_{vo} = 200.0600 V/V$

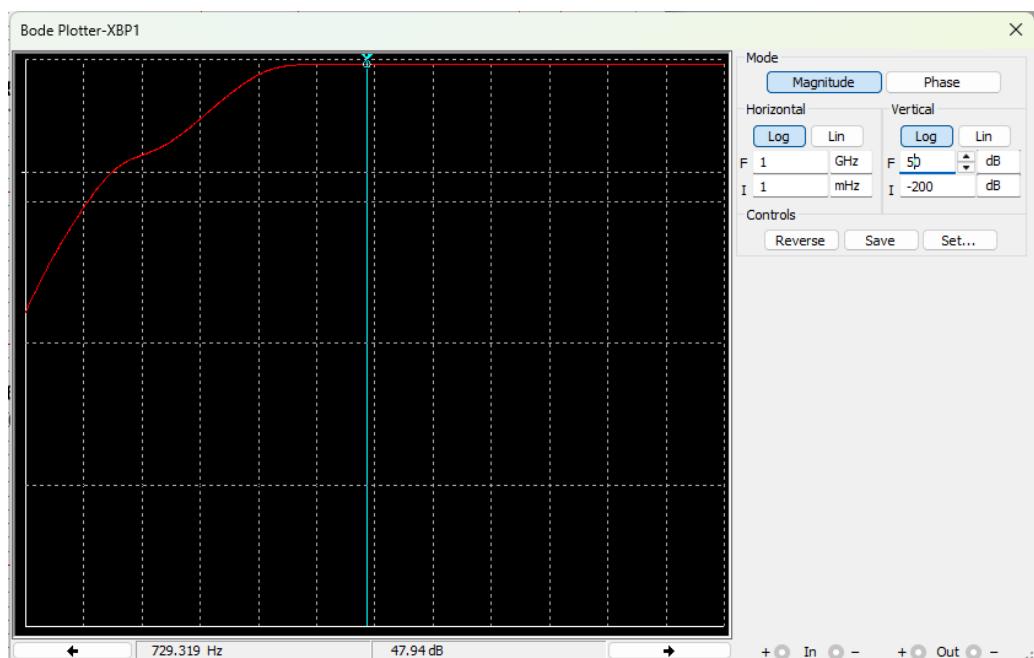
$$- A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out3}} = 193.3913 V/V$$

$\Rightarrow A_v = 193.3913 V/V$

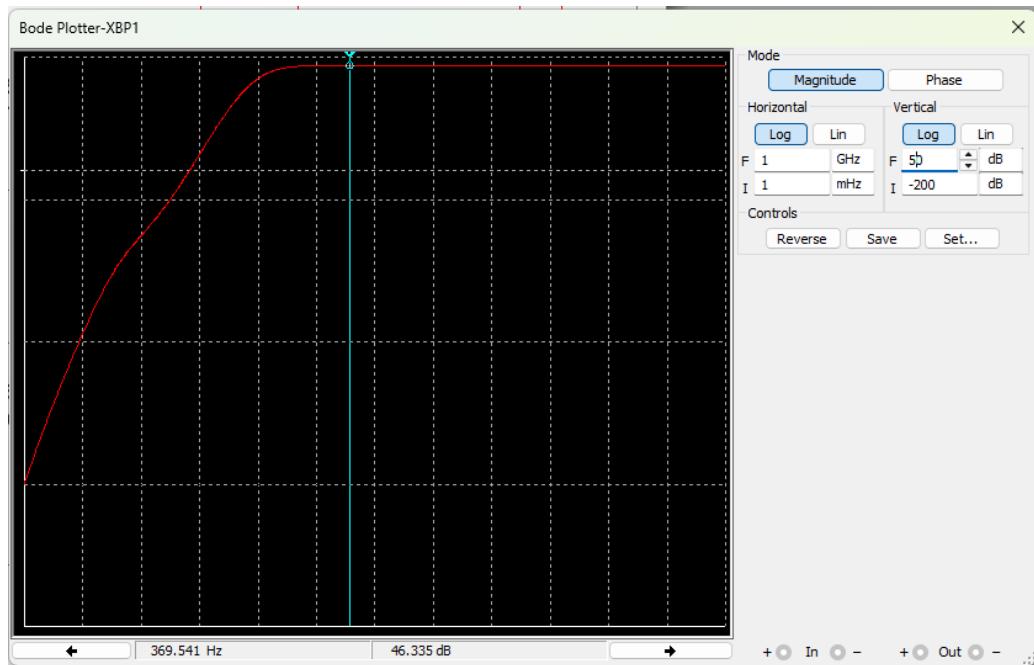
$$- G_v = \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_s} A_v = 191.0038 V/V$$

$\Rightarrow G_v = 191.0038 V/V$

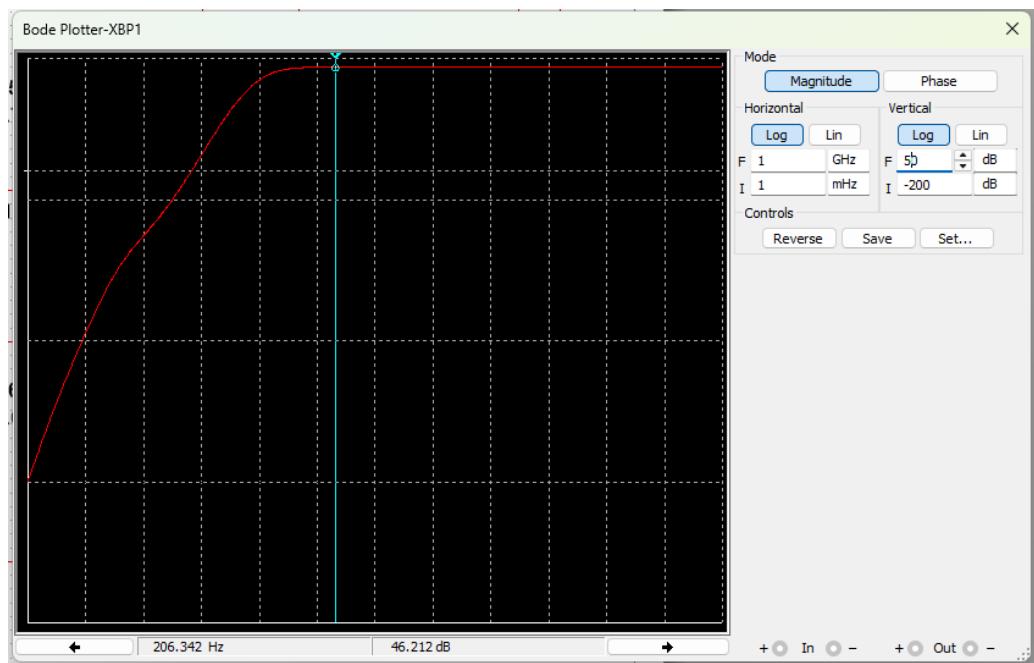
Kiểm tra kết quả



Hình 12: Với  $A_{vo} = 47.94db = 249.44595 V/V$ .



Hình 13: Với  $A_v = 46.335 \text{db} = 207.3719 \text{V/V}$ .

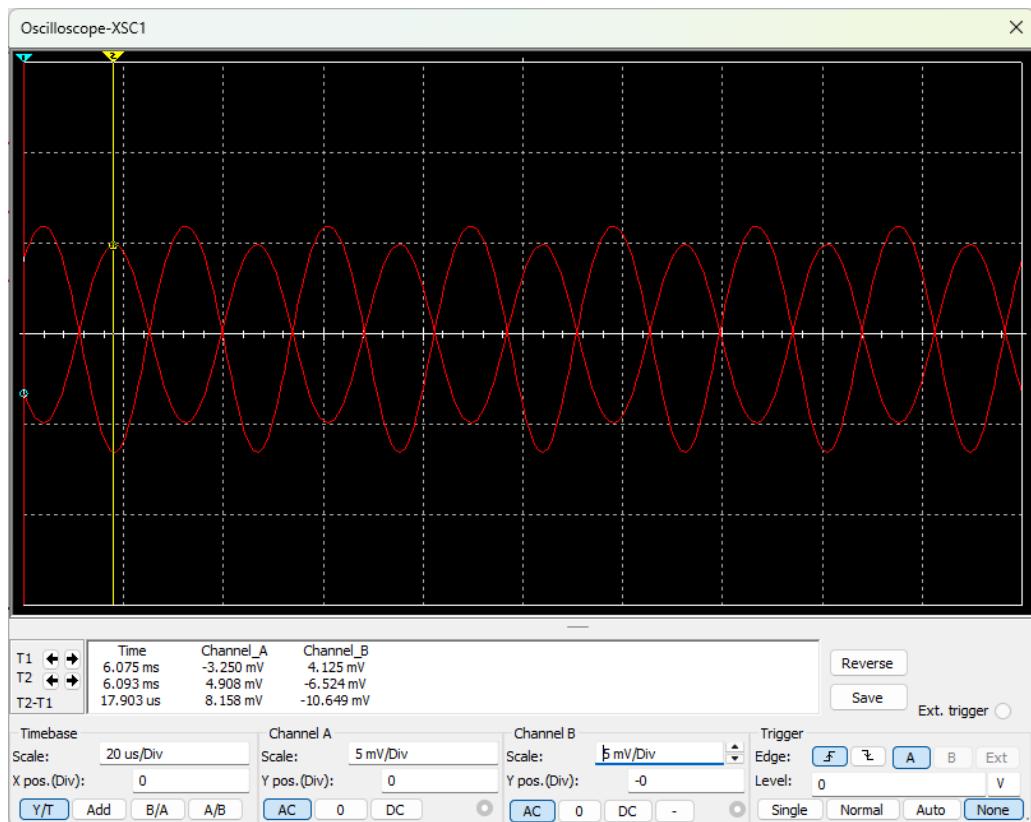


Hình 14: Với  $G_v = 46.121 \text{db} = 202.3252 \text{V/V}$ .

c ) Vẽ dạng sóng ngõ vs và vo khi đi qua từng tầng (vị trí trước khi đi qua tụ ghép).

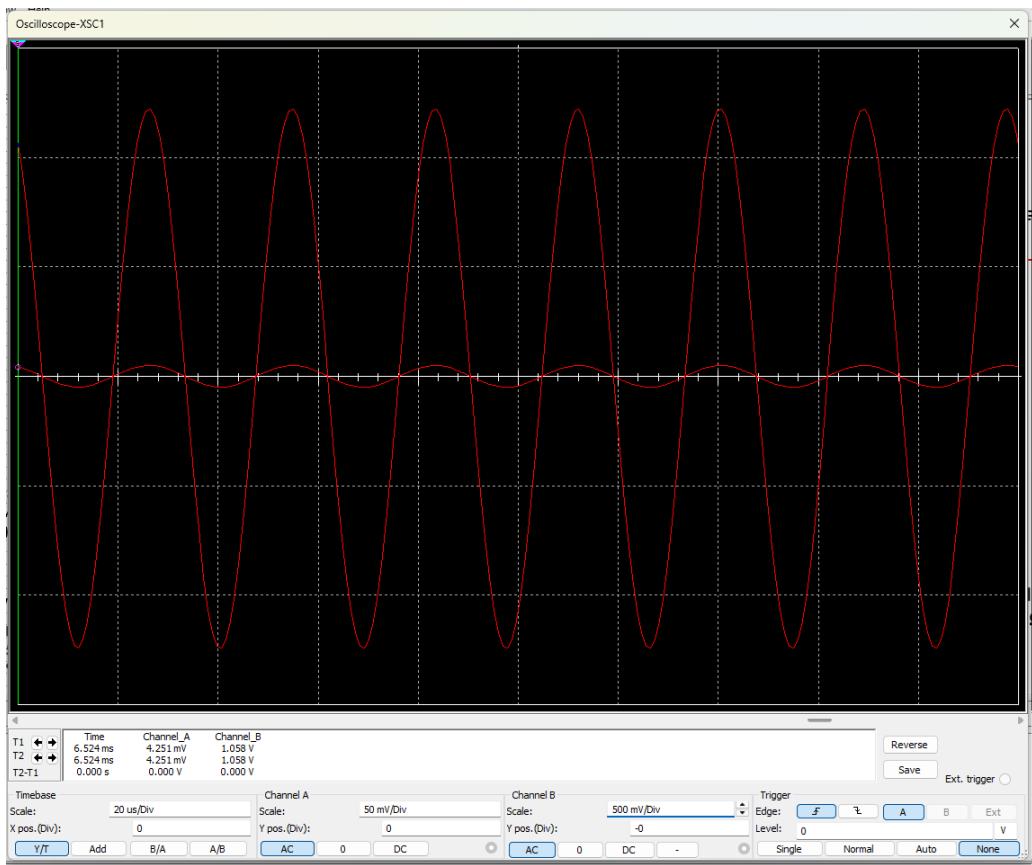
Cho  $V_s = 5 \sin(\Omega t)$  (mV)

- Qua tầng đầu tiên, Tầng 1



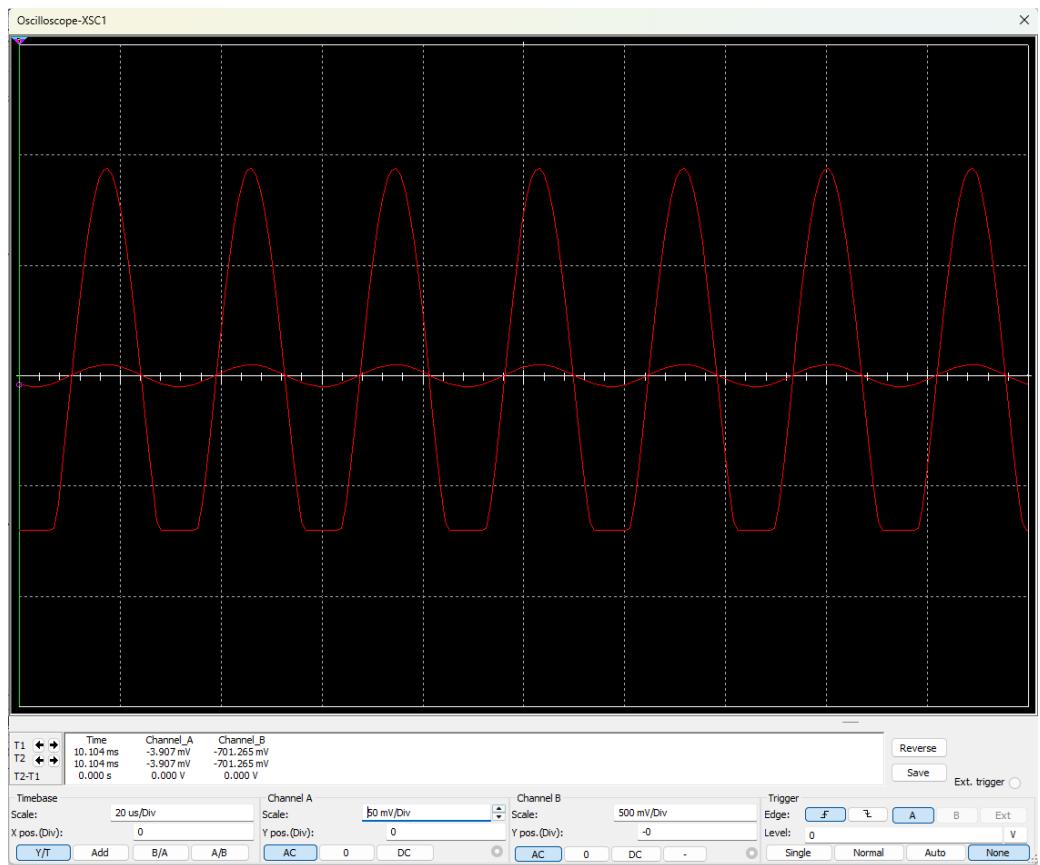
Ta thấy với  $A_{vo1} = -8.4765 \text{ V/V}$  với tính toán thì sóng bị đảo pha so với sóng ban đầu và được khuếch đại lên 8.4765 lần.

- Qua tầng tiếp theo, Tầng 2



Sau khi qua tầng 2 với  $A_{vo2} = -238.76 \text{ V/V}$ , thì dạng sóng được đưa về đúng pha ban đầu và được khuếch đại lên thêm để có trị rất lớn so với ngõ vào.

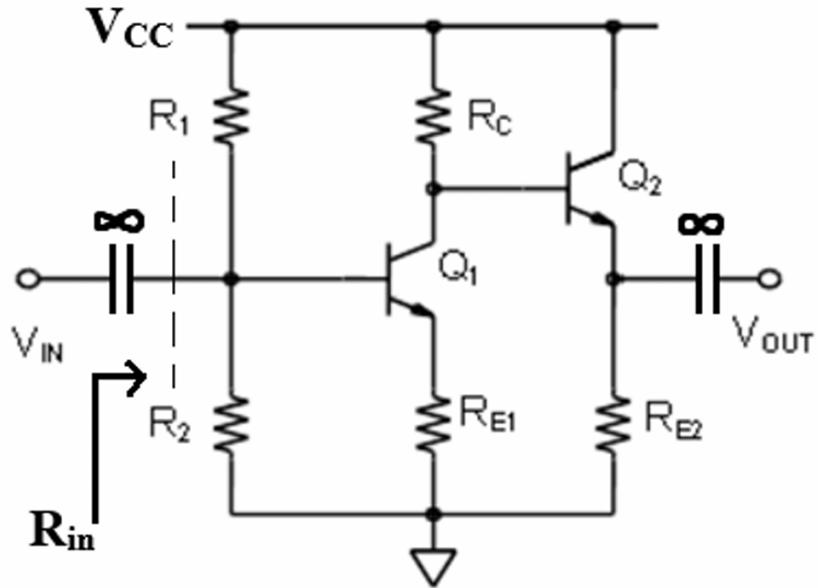
- Tầng cuối cùng, Tầng 3



Sau khi qua tầng 3 thì tín hiệu bị xén phía bên dưới, chúng tò điểm phân cực  $Q_3$  cần được điều chỉnh lại để có thể lấy được trọn tín hiệu.

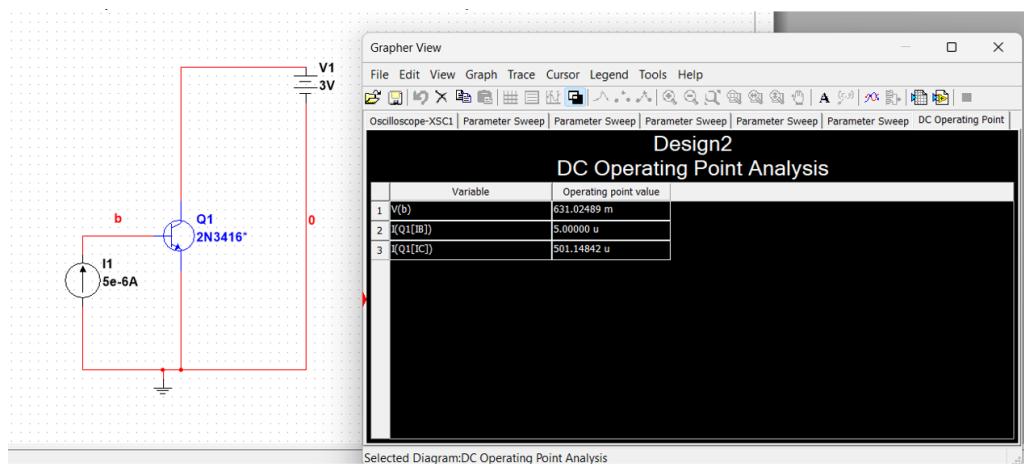
## Câu 9

Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Mạch có  $V_{CC} = 9V$ . BJT  $Q_1$  và  $Q_2$  có hệ số  $\beta = 100$ . Các hệ số  $V_A = \infty$ .

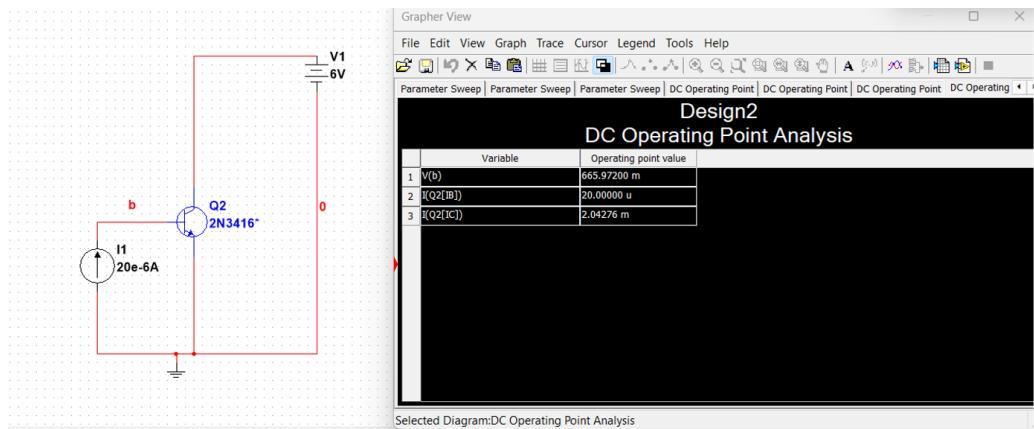


a ) Thiết kế mạch để có  $Q_1(0.5\text{mA}, 3\text{V})$ ;  $Q_2(2\text{mA}, 6\text{V})$ .

Sweep bf cho đến khi thỏa mãn điểm  $Q$



Hình 15: Chọn transistor  $Q_1$  thỏa mãn  $\beta = 100$  ứng với  $I_{C1} = 0.5\text{mA}$  và  $V_{CE1} = 3\text{V}$  (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 153 so với 157 ban đầu);  $V_{be} = 0.63\text{V}$



Hình 16: Chọn transistor  $Q_2$  thỏa mãn  $\beta = 100$  ứng với  $I_{C2} = 2 \text{ mA}$  và  $V_{CE2} = 6 \text{ V}$  (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu);  $V_{be} = 0.665 \text{ V}$

$$R_{TH} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

$$V_{TH} - V_{BE1} = I_{C1} \left( \frac{R_{TH}}{\beta} + R_{E1} \right) \quad (3)$$

$$V_{CC} - V_{CEQ1} = (I_{CQ1} + \frac{I_{CQ2}}{\beta}) R_C + I_{CQ1} R_{E1} \quad (4)$$

$$V_{CC} - V_{BE2} = (I_{CQ1} + \frac{I_{CQ2}}{\beta}) R_C + I_{CQ2} R_{E2} \quad (5)$$

$$V_{CC} - V_{CEQ2} = I_{CQ2} R_{E2} \quad (6)$$

$$\Rightarrow 9 - 6 = 2R_{E2}$$

$$\Rightarrow R_{E2} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

Thết  $R_{E2}$  vào (5):

---

$$9 - 0.665 = 0.52R_C + 2 \times 1.5$$

$$\Rightarrow R_C = 10.26 \text{ k}\Omega$$

Thay  $R_C$  vào (4):

$$9 - 3 = 0.52 \times 10.26 + 0.5R_{E1}$$

$$\Rightarrow R_{E1} = 1.33 \text{ k}\Omega$$

$$I_{CQ1} = \frac{(V_{TH} - V_{BE1})\beta}{R_{TH} + (\beta + 1)R_{E1}} \quad (7)$$

Chọn  $R_{TH} \ll (\beta + 1)R_{E1}$  để dòng  $I_C$  ổn định.

$$\Rightarrow R_{TH} \ll 134.33 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH} = 13.433 \text{ k}\Omega$$

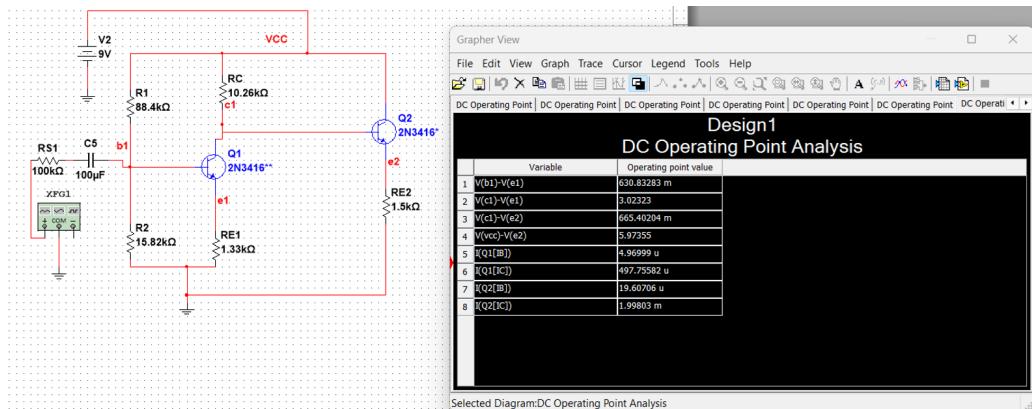
Từ (3):

$$V_{TH} - 0.63 = 0.5 \left( \frac{13.433}{100} + 1.33 \right) \Rightarrow V_{TH} = 1.36 \text{ V}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.151 \Rightarrow 5.62R_2 = R_1$$

Với  $R_{TH} = 13.433 \text{ k}\Omega$ :

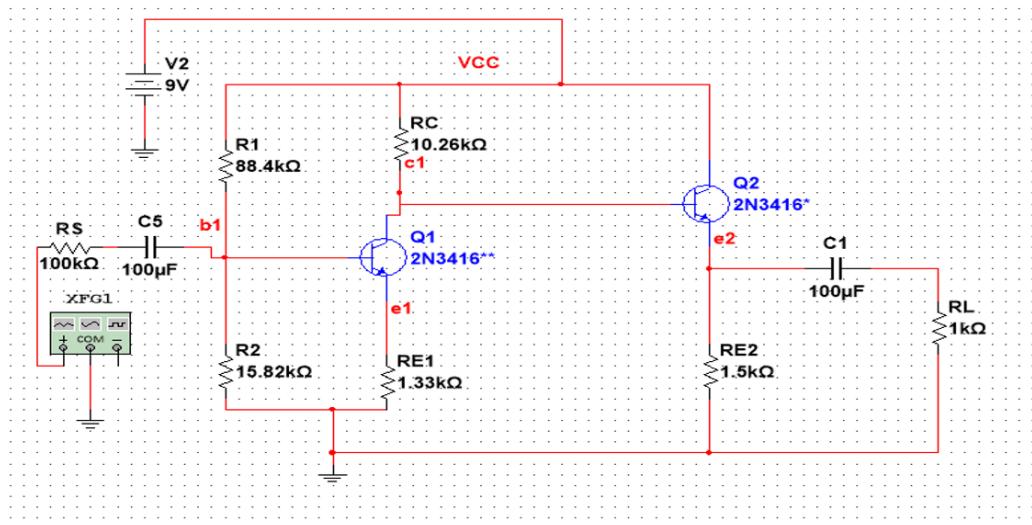
$$\Rightarrow R_2 = 15.73 \text{ k}\Omega \text{ và } R_1 = 88.4 \text{ k}\Omega$$



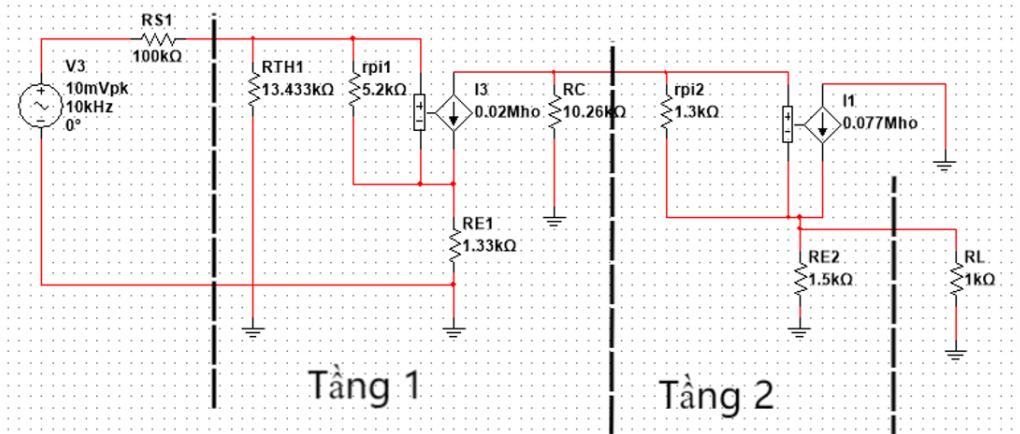
Hình 17: DC Point.

b ) Đặt nguồn  $v_s = V_m \sin(\omega t)$  có nội trở  $R_S = 100 \text{ k}\Omega$  vào mạch. Ngõ ra nối với tải  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ . Tìm  $A_{vo}$ ,  $A_v$ ,  $G_v$ ,  $R_i$ ,  $R_o$  của mạch.

Từ kết quả câu a ta có mạch như sau,



Ta chia thành 2 tầng như sau:



$$+ r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26100}{0.5} = 5.2 k\Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26100}{2} = 1.3 k\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 (\text{S})$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 (\text{S})$$

- Tầng 1

$$+ R_{in1} = R_{TH1} // (r_{\pi 1} + (\beta + 1)R_{E1}) = 13.433 k // (5.2 k + 101 \times 1.33 k) = 12.25 k\Omega$$

$$+ R_{out1} = R_{C1} = 10.26 k\Omega$$

$$+ A_{V1} = \frac{-\beta R_C}{r_{\pi 1} + (\beta + 1)R_{E1}} = \frac{-10010.26 k}{5.2 k + 1011.33 k} = -7.35 (\text{V/V})$$

- Tầng 2

$$+ R_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1)R_{E2} = 1.3 k + 101 \times 1.5 k = 152.8 k\Omega$$

$$+ R_{out2} = R_{E2} // \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)} = 1.5 k // \frac{1.3 k}{101} = 0.0137 k\Omega$$

$$+ A_{V2} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)}} = \frac{1.5 k}{1.5 k + \frac{1.3 k}{101}} = 0.99 (\text{V/V})$$

- Toàn bộ tầng

$$+ R_{in} = R_{in1} = 12.25 k\Omega$$

$$+ \quad R_{out} = R_{out2} = 0.013 \text{ k}\Omega$$

$$+ \quad A_{vo} = A_{v1}A_{v2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = -6.82 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad A_{vo} = -6.82 \text{ (V/V)}$$

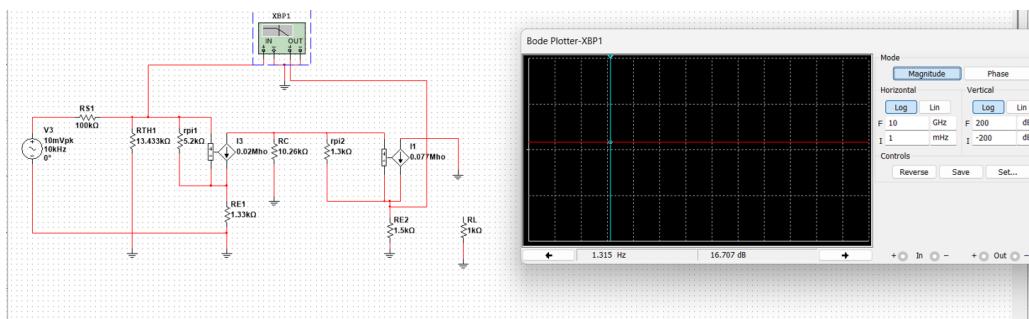
$$+ \quad A_V = A_{V0} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = -6.73 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad A_v = -6.73 \text{ (V/V)}$$

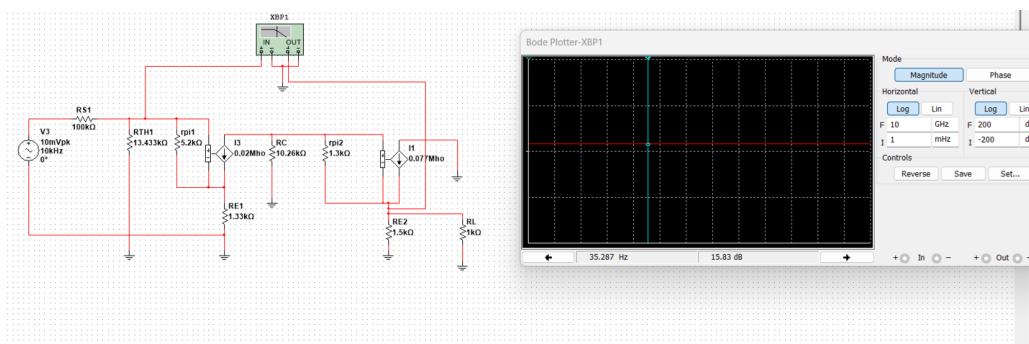
$$+ \quad G_V = A_V \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = -0.73 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad G_v = -0.73 \text{ (V/V)}$$

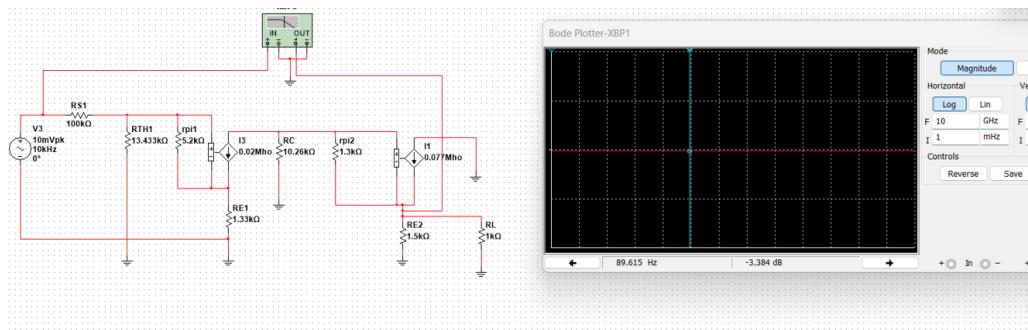
- Kiểm tra kết quả



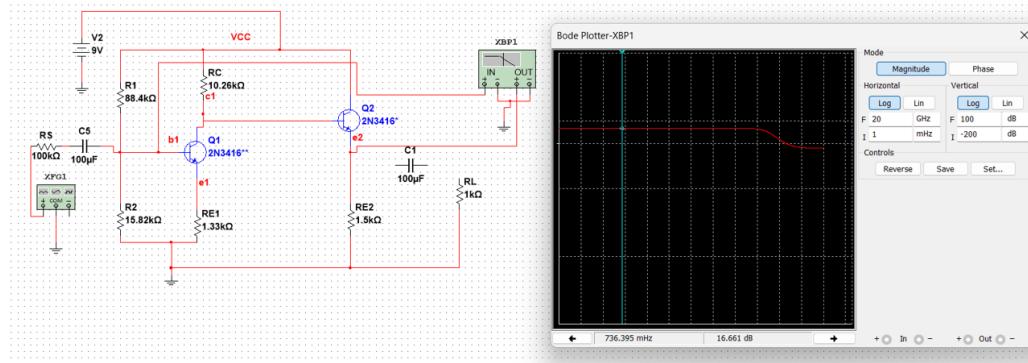
Hình 18: Do  $|A_{V0}| = 16.707 \text{ dB} = 6.84 \text{ V/V}$  (mô hình tương đương)



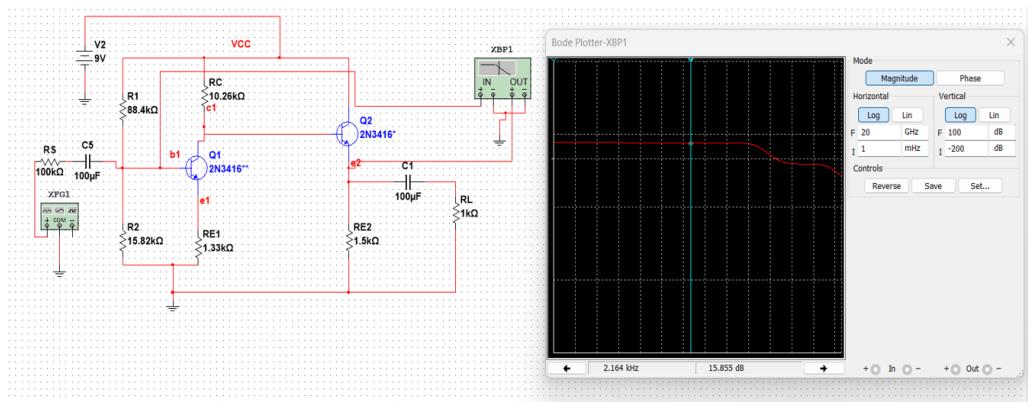
Hình 19: Do  $|A_V| = 15.83 \text{ dB} = 6.187 \text{ V/V}$  (mô hình tương đương)



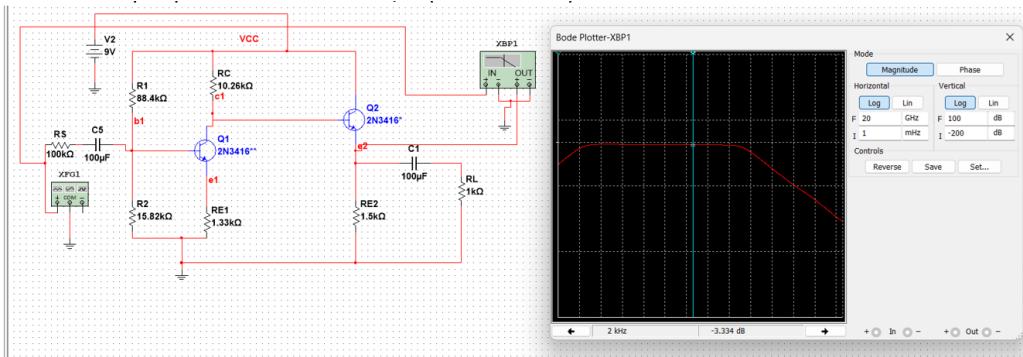
Hình 20: Đo  $|G_V| = -3.384 \text{ dB} = 0.677 \text{ V/V}$  (mô hình tương đương)



Hình 21: Đo  $|A_{V0}| = 16.661 \text{ dB} = 6.77 \text{ V/V}$  (tổng mạch)

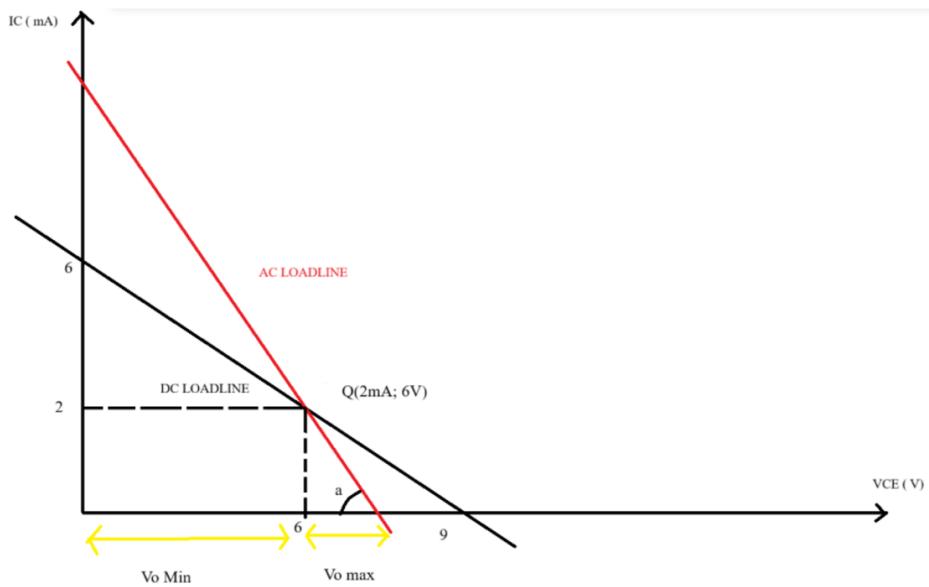


Hình 22: Đo  $|A_V| = 15.855 \text{ dB} = 6.20 \text{ V/V}$  (tổng mạch)



Hình 23: Do  $|G_V| = -3.34 \text{ dB} = 0.68 \text{ V/V}$  (tòan mạch)

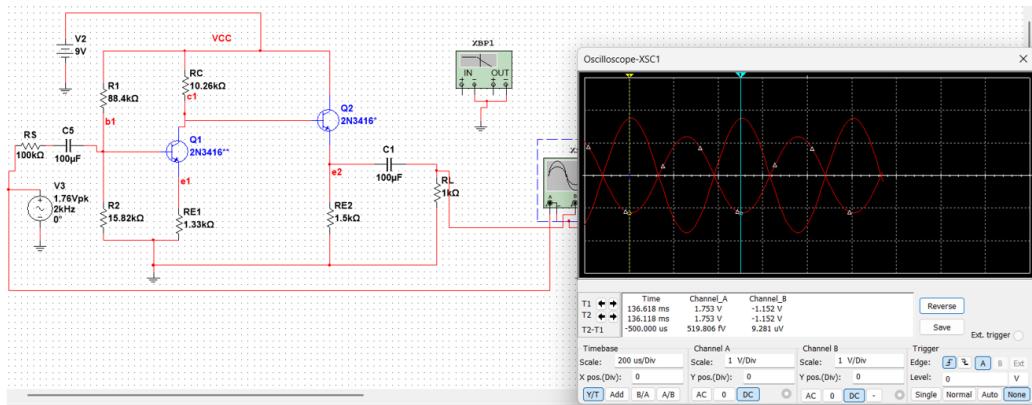
c ) Tìm biên độ lớn nhất của  $V_m$  để để  $v_s$  là tín hiệu nhỏ ở cả hai tầng.



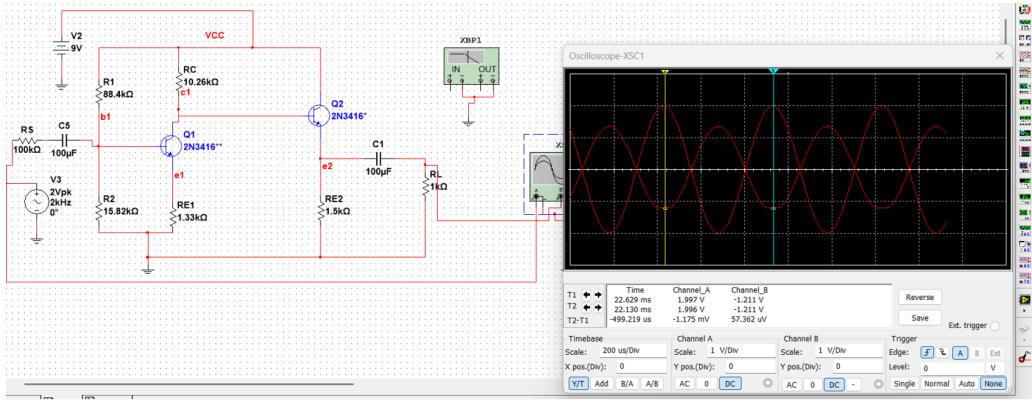
$$\tan(\alpha) = \frac{1}{R_L//R_{E2}} = \frac{1}{0.6 k} \Rightarrow V_{o,\max} = \frac{I_{CQ2}}{\tan(\alpha)} = 1.2 \text{ V}$$

$$V_{\text{sig,max}} = \frac{V_{o,\max}}{G_V(f = 2 \text{ kHz})} = \frac{1.2}{0.68} = 1.76 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig,max}} = 1.76 \text{ V}$$

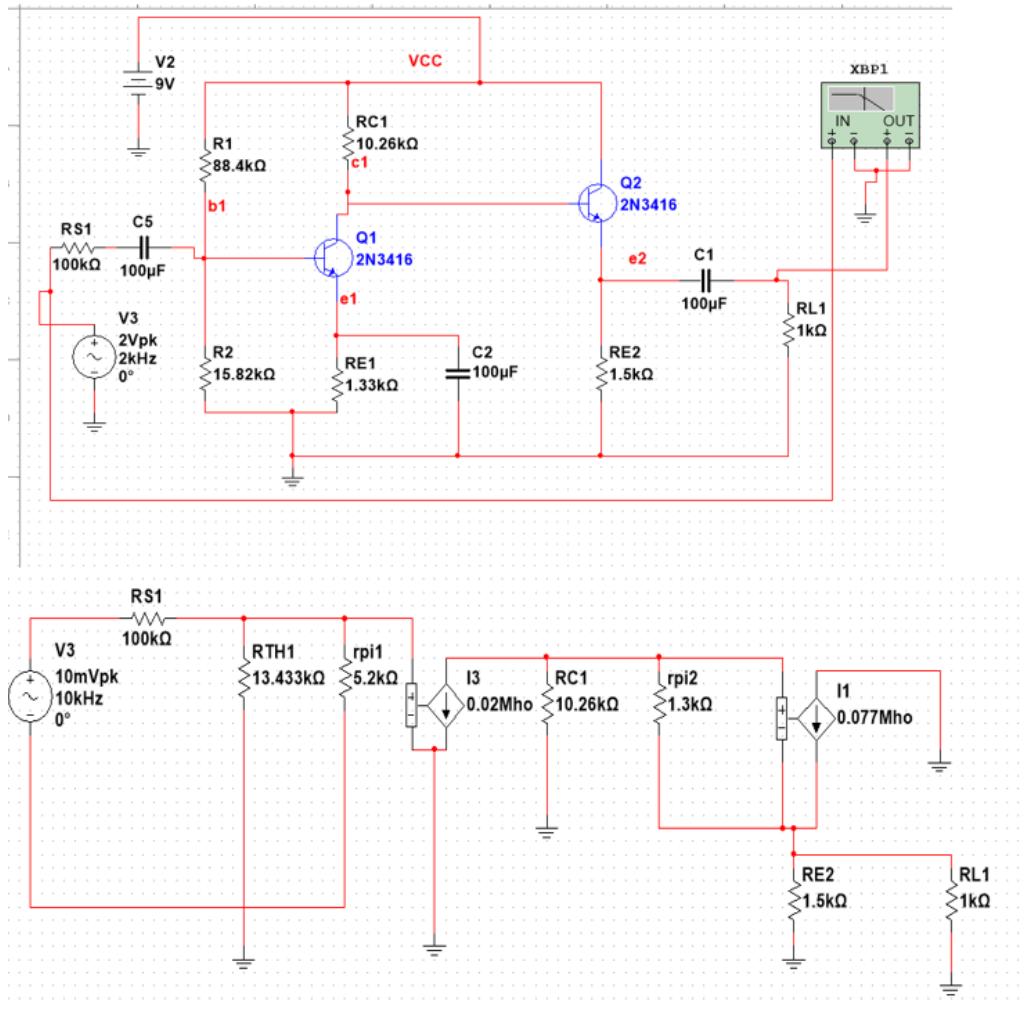


Hình 24:  $V_{p,\text{sig}} = 1.76 \text{ V}$ ;  $V_{pL} = -1.152 \text{ V}$ ;  $G_V = -0.654 \text{ (V/V)}$



Hình 25:  $V_{p,\text{sig}} = 2 \text{ V}$ ;  $V_{pL} = -1.211 \text{ V}$ ;  $G_V = -0.6055 \text{ (V/V)}$  (ngõ ra đã bị xén dưới)

d ) Thiết kế mắc thêm tụ  $C$  để cải thiện độ lợi của mạch. Tính lại  $G_v$ ,  $R_i$ ,  $R_o$  của mạch.



Hình 26: Mắc các tụ  $C$  vào mạch.

$$+ r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26 \times 100}{0.5} = 5.2 k\Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26 \times 100}{2} = 1.3 k\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 (\text{S})$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 (\text{S})$$

- Tầng 1

$$\begin{aligned}+ R_{in1} &= R_{TH1} // r_{\pi 1} = 13.433 k // 5.2 k = 3.75 k\Omega \\+ R_{out1} &= R_C = 10.26 k\Omega \\+ A_{V1} &= -g_{m1}R_C = -0.02 \times 10.26 k = -205.2 (\text{V/V})\end{aligned}$$

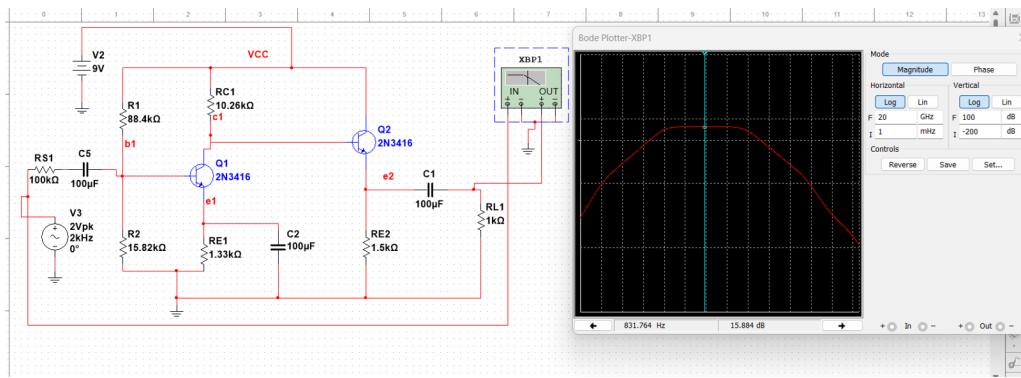
- Tầng 2

$$\begin{aligned}+ R_{in2} &= r_{\pi 2} + (\beta + 1)R_{E2} = 1.3 k + 101 \times 1.5 k = 152.8 k\Omega \\+ R_{out2} &= R_{E2} // \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)} = 1.5 k // \frac{1.3 k}{101} = 0.0137 k\Omega \\+ A_{V2} &= \frac{R_{E2}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)}} = \frac{1.5 k}{1.5 k + \frac{1.3 k}{101}} = 0.99 (\text{V/V})\end{aligned}$$

- Toàn bộ tầng

$$\begin{aligned}&+ R_{in} = R_{in1} = 3.75 k\Omega \\&+ R_{out} = R_{out2} = 0.013 k\Omega \\+ A_{V0} &= A_{V1}A_{V2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = -190.36 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow A_{V0} = -190.36 (\text{V/V}) \\+ A_V &= A_{V0} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = -187.92 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow A_V = -187.92 (\text{V/V}) \\+ G_V &= A_V \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = -6.79 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow G_V = -6.79 (\text{V/V})\end{aligned}$$

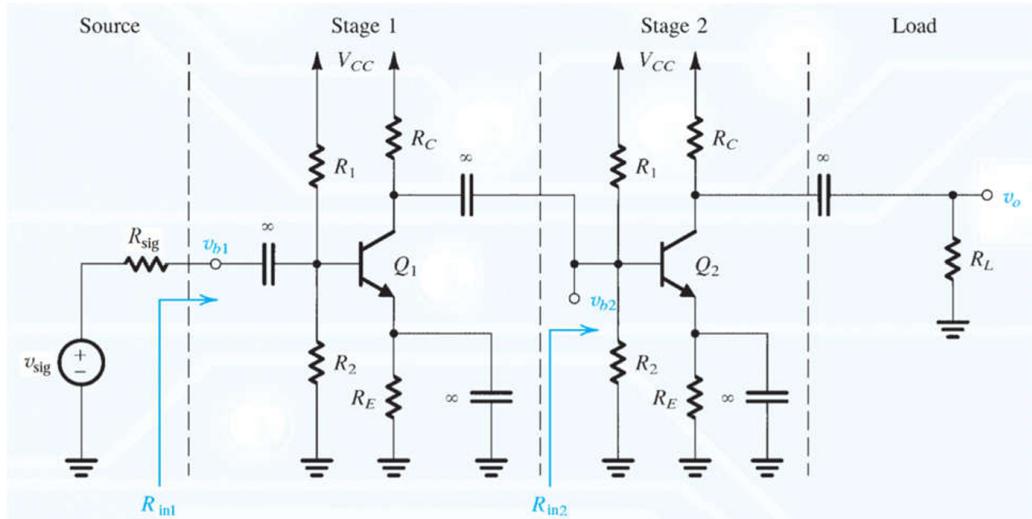
- Kiểm tra kết quả



Hình 27: Do  $|G_v| = 15.884 \text{db} = 6.225 (\text{V/V})$

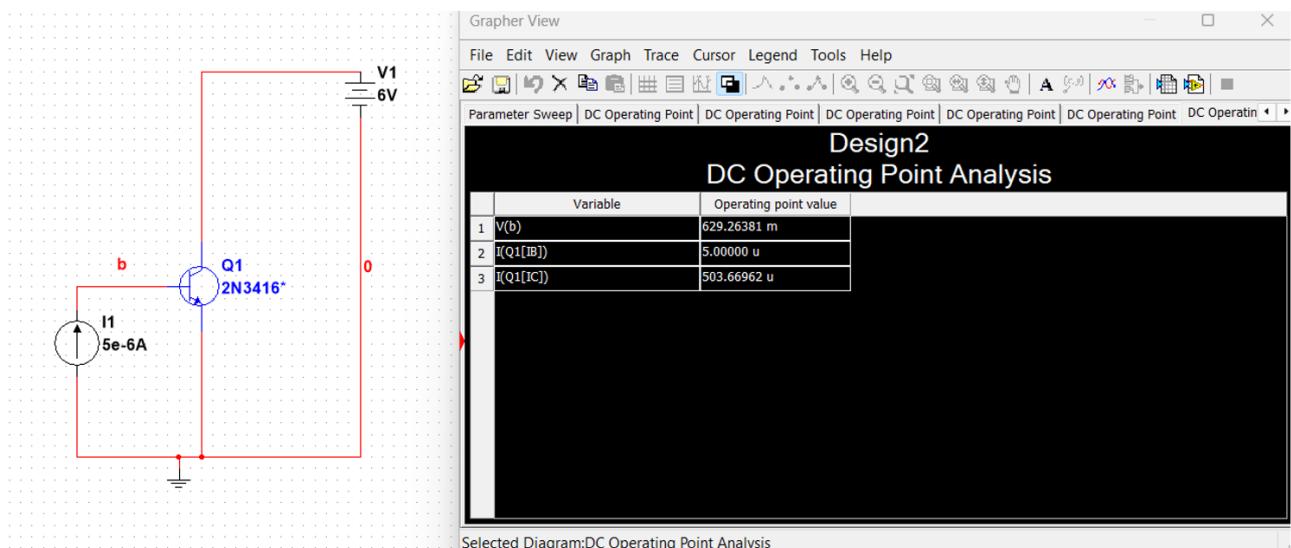
## Câu 10

Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Mạch có  $V_{CC} = 9V$ . BJT  $Q_1$  và  $Q_2$  có hệ số  $\beta = 100$ . Các hệ số  $V_A = \infty$ .



a) Thiết kế để có  $Q_1(0.5mA, 6V)$ ,  $Q_2(2mA, 6V)$

- Xét tầng 1 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điều kiện Q)



Hình 28: Chọn transistor  $Q_1$  thỏa mãn  $\beta = 100$  ứng với  $I_{C1} = 0.5mA$  và  $V_{CE1} = 6V$  (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 140 so với 157 ban đầu);  $V_{BE1} = 0.63V$

---

Ta có:  $Q_1(I_{CQ1} = 0.5mA, V_{CEQ1} = 6V)$

Ta có:

$$R_{TH1} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

Từ phương trình mạch:

$$\begin{aligned} V_{CC} - V_{CEQ1} &= I_{CQ1}(R_C + R_E) \\ \Rightarrow 9 - 6 &= 0.5(R_C + R_E) \\ \Rightarrow R_C + R_E &= 6 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3)$$

Công thức dòng collector:

$$I_{CQ1} = \frac{(V_{TH1} - V_{BE1})\beta}{R_{TH1} + (\beta + 1)R_E} \quad (4)$$

Chọn  $R_{TH1} \ll (\beta + 1)R_E$  để dòng  $I_C$  ổn định.

Giả sử chọn:

$$R_E = 2 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH1} \ll 202 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH1} = 20.2 \text{ k}\Omega$$

Thay  $R_{TH1}$  và  $R_E$  vào (4), ta được:

$$V_{TH1} = 1.741 \text{ V}$$

Từ (3):

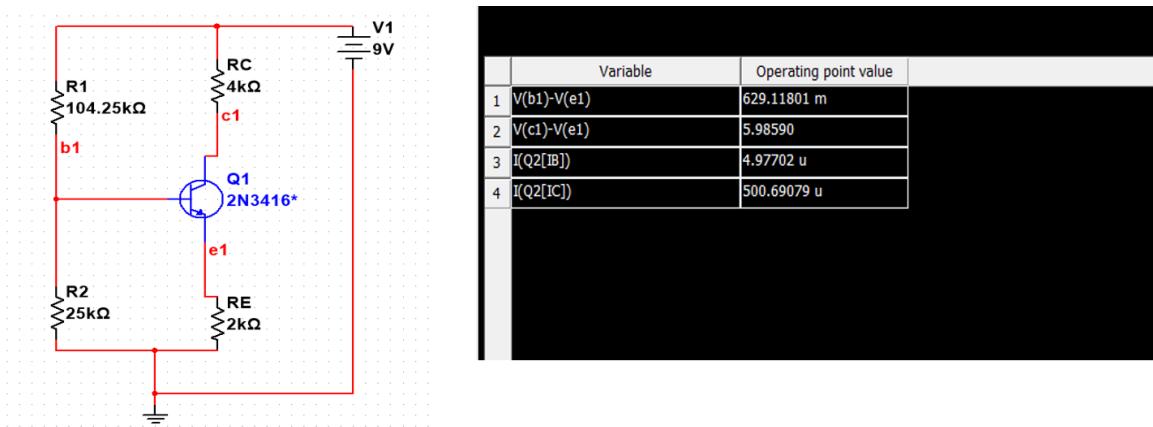
$$R_C = 4 \text{ k}\Omega$$

Từ (2):

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.1934 \Rightarrow 4.17R_2 = R_1$$

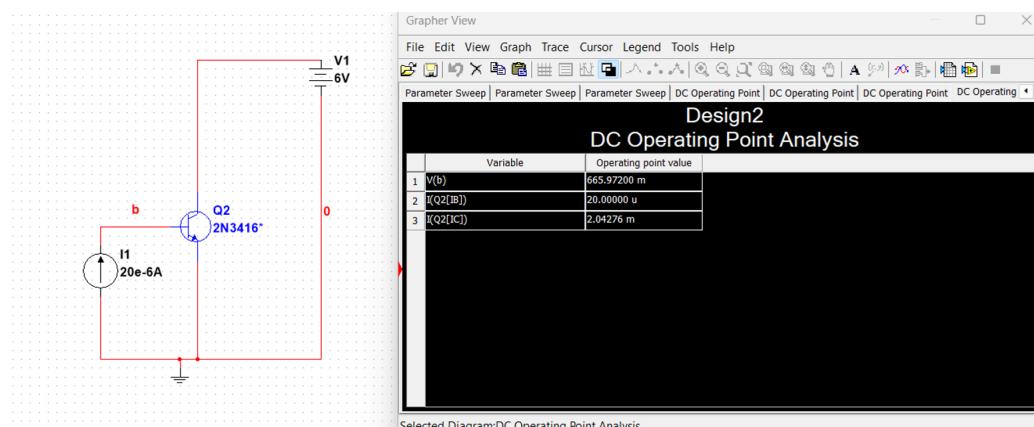
Lại có:

$$\begin{aligned} R_1 // R_2 &= 20.2 \text{ k}\Omega \\ \Rightarrow R_2 &= 25 \text{ k}\Omega, \quad R_1 = 104.25 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



Hình 29: Mạch Bias cho tầng 1 và mô phỏng điểm Q tầng 1

- Xét tầng 2 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q)



Hình 30: Chọn transistor  $Q_2$  thỏa mãn  $\beta = 100$  ứng với  $I_{C2} = 2mA$  và  $V_{CE2} = 6V$  (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu);  $V_{BE2} = 0.665V$ .

Ta có:  $Q_2(I_{CQ2} = 2mA, V_{CEQ2} = 6V)$

Ta có:

$$R_{TH2} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

Phương trình mạch:

$$\begin{aligned} V_{CC} - V_{CEQ2} &= I_{CQ2}(R_C + R_E) \\ \Rightarrow 9 - 6 &= 2(R_C + R_E) \\ \Rightarrow R_C + R_E &= 1.5 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3)$$

Công thức dòng collector:

$$I_{CQ2} = \frac{(V_{TH2} - V_{BE2})\beta}{R_{TH2} + (\beta + 1)R_E} \quad (4)$$

Chọn  $R_{TH2} \ll (\beta + 1)R_E$  để dòng  $I_C$  ổn định.

Giả sử chọn:  $R_E = 500 \Omega$

$$\Rightarrow R_{TH2} \ll 50.5 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH2} = 5.05 \text{ k}\Omega$$

Thay  $R_{TH2}$  và  $R_E$  vào (4), ta được:

$$V_{TH2} = 1.776 \text{ V}$$

Từ (3):

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

Từ (2):

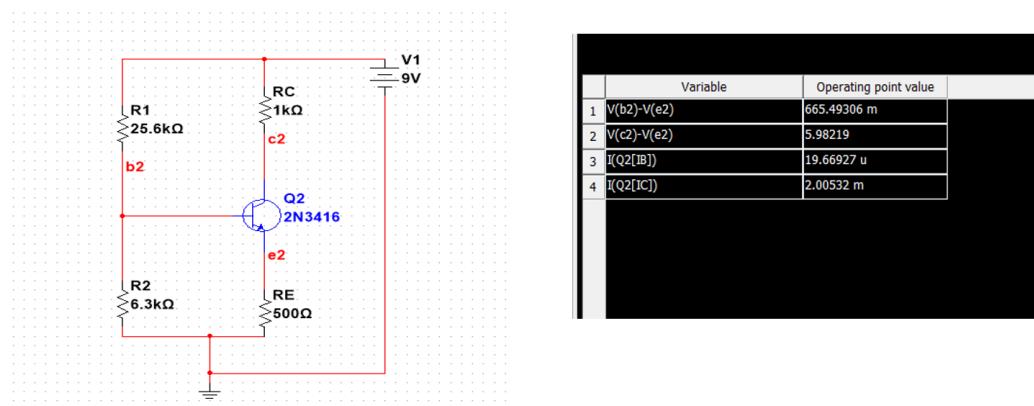
$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.1973 \Rightarrow 4.07R_2 = R_1$$

Lại có:

$$R_1//R_2 = 5.05 \text{ k}\Omega$$

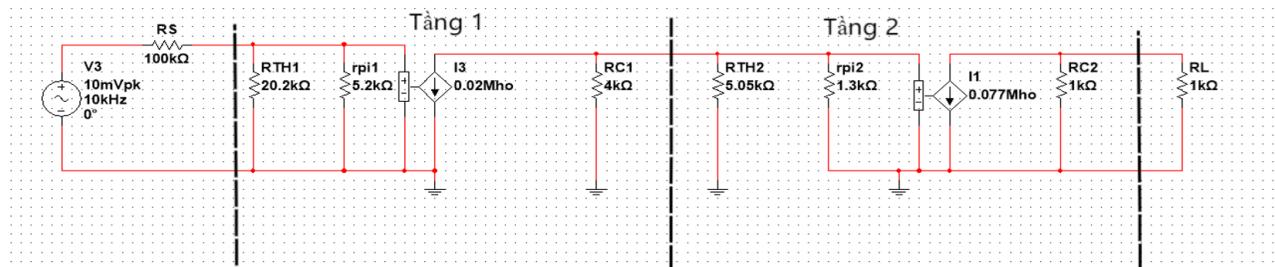
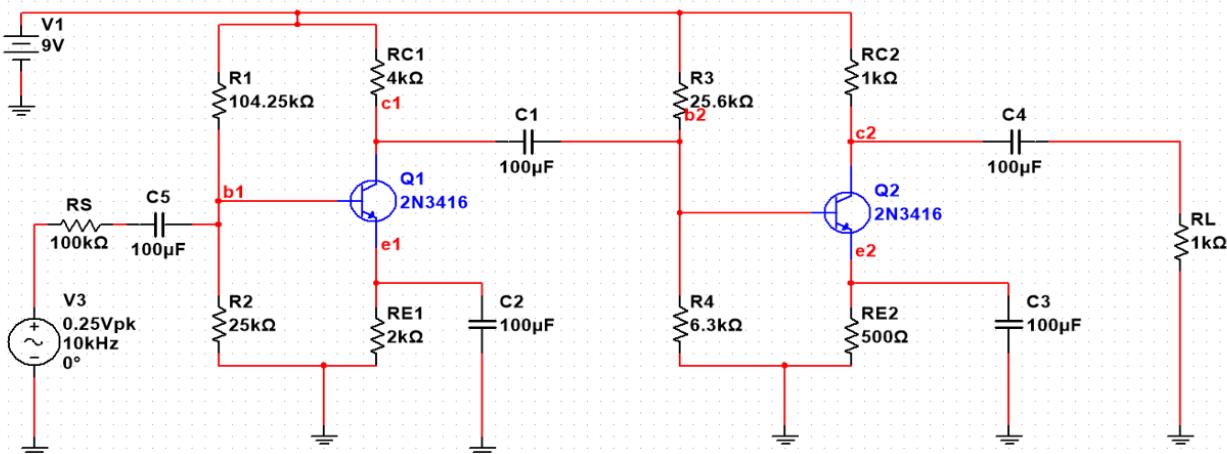
$$\Rightarrow R_2 = 6.3 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 25.6 \text{ k}\Omega$$



Hình 31: Mạch Bias cho tầng 2 và mô phỏng điểm Q tầng 2

b ) Đặt nguồn  $v_s = V_m \sin(\omega t)$  có nội trở  $R_S = 100k\Omega$  vào mạch. Ngõ ra nối với tải  $R_L = 1k\Omega$ . Tìm  $A_{vo}$ ,  $A_v$ ,  $G_v$ ,  $R_{in}$ ,  $R_{out}$  của mạch.



Hình 32: mô hình tín hiệu nhỏ.

- Các thông số cơ bản:

$$r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \times \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26 \times 100}{0.5} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \times \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26 \times 100}{2} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 \text{ (S)}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 \text{ (S)}$$

- Tại tầng 1:

$$R_{in1} = R_{TH1} // r_{\pi 1} = 20.2 \text{ k} // 5.2 \text{ k} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out1} = R_{C1} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$A_{V1} = -g_{m1} \times R_{C1} = -0.02 \times 4 \text{ k} = -80 \text{ (V/V)}$$

- Tại tầng 2:

$$R_{in2} = R_{TH2} // r_{\pi 2} = 5.05 \text{ k} // 1.3 \text{ k} = 1.03 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out2} = R_{C2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_{V2} = -g_{m2} \times R_{C2} = -0.077 \times 1 \text{ k} = -77 \text{ (V/V)}$$

- Tính  $A_{vo}$ ,  $A_v$ ,  $R_{in}$ ,  $R_{out}$  cho toàn bộ mạch

$$\Rightarrow R_{in} = R_{in1} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{out} = R_{out2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v0} = A_{V1} \times A_{V2} \times \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = (-80) \times (-77) \times \frac{1.03}{4 + 1.03} = 1261 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow A_{v0} = 1261 \text{ (V/V)}.$$

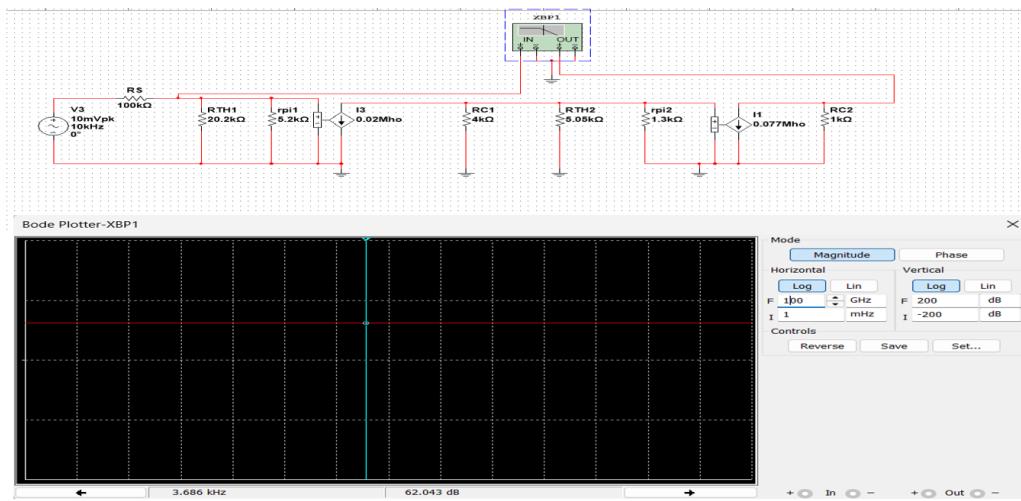
$$A_v = A_{v0} \times \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = 1261 \times \frac{1}{1 + 1} = 630.7 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow A_v = 630.7 \text{ (V/V)}.$$

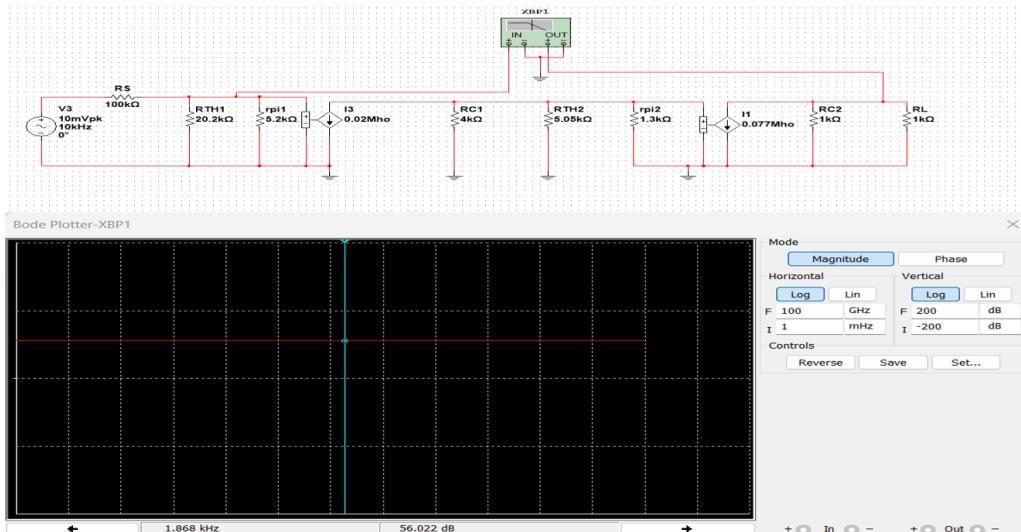
$$G_v = A_v \times \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = 630.7 \times \frac{4}{4 + 100} = 24.2 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow G_v = 24.2 \text{ (V/V)}$$

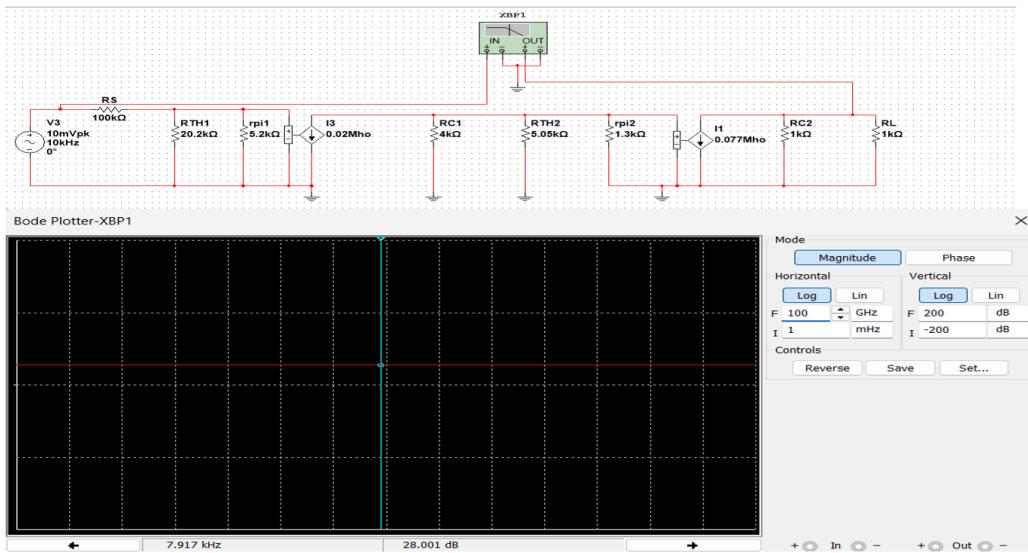
- Kết quả đo thực nghiệm:



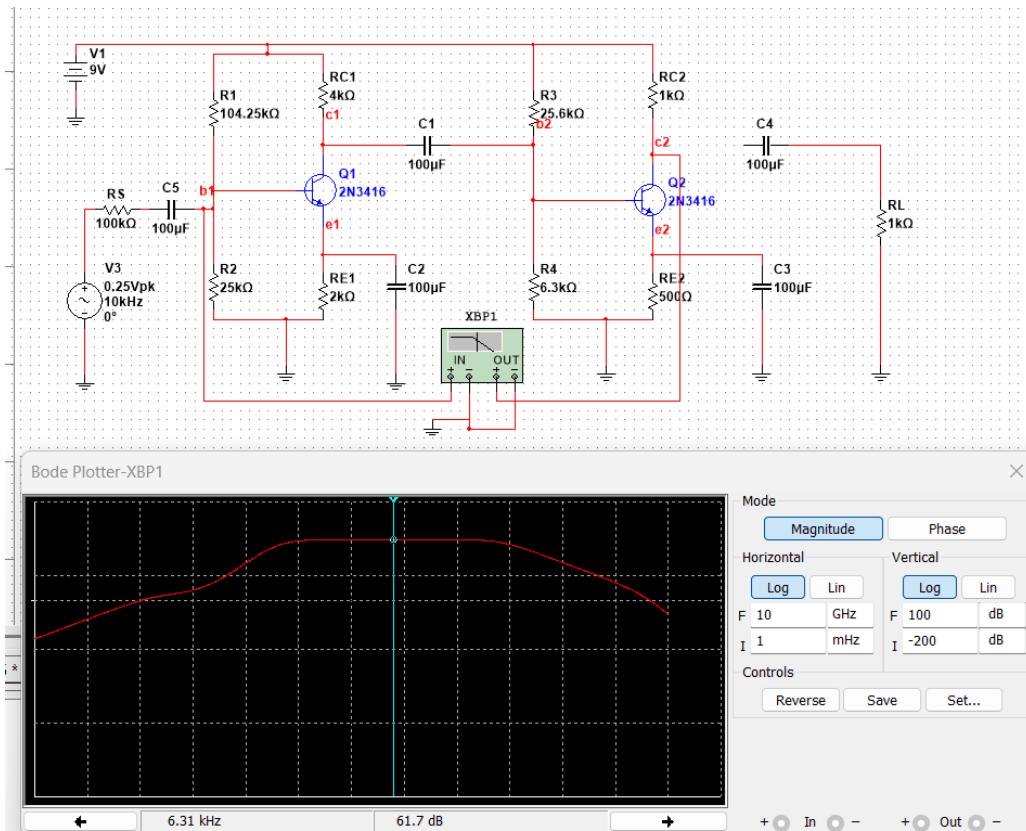
Hình 33: Do  $A_{vo} = 62.043\text{db} = 1258V/V$  (mô hình tương đương).



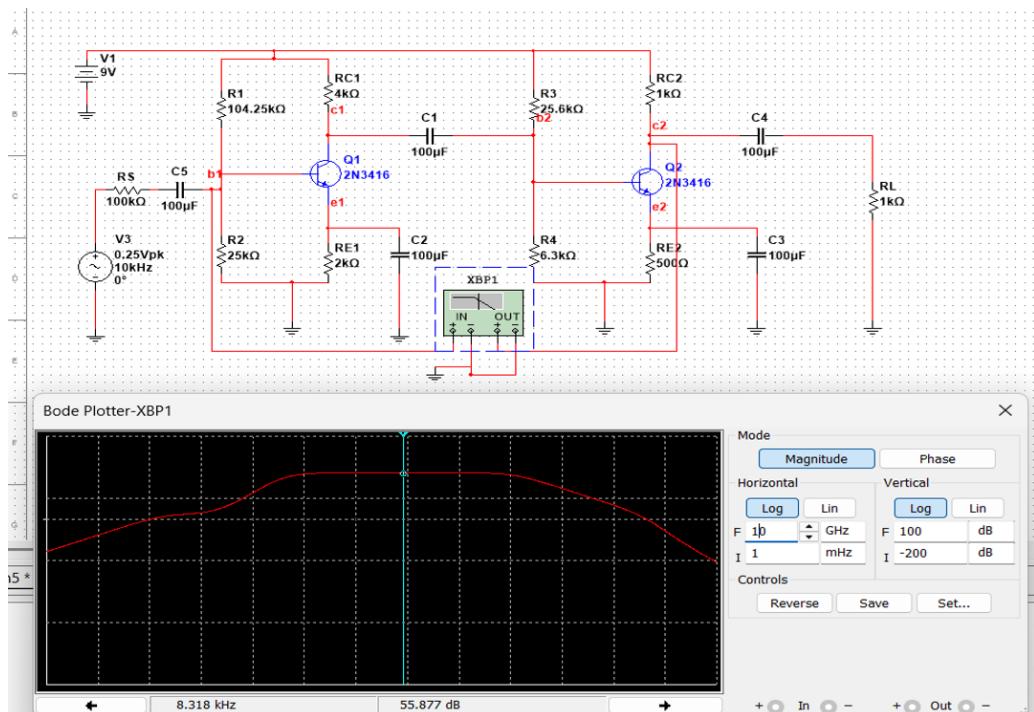
Hình 34: Do  $A_v = 56.022\text{db} = 632.55V/V$  (mô hình tương đương).



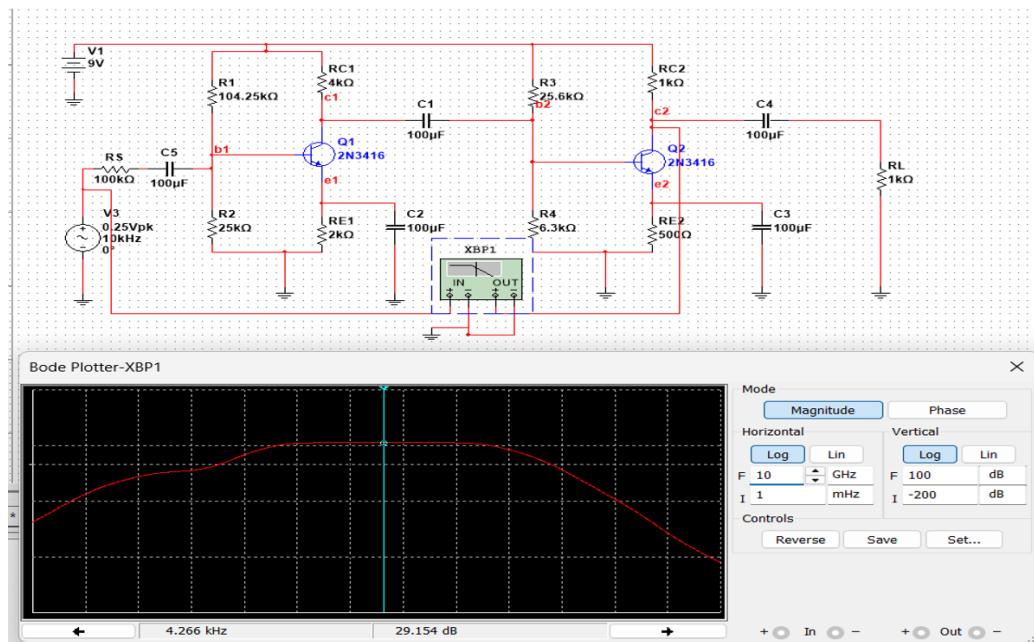
Hình 35: Do  $G_v = 28db = 25.11V/V$  (mô hình tương đương).



Hình 36: Do  $A_{vo} = 61.7db = 1216V/V$  (tổn mạch).



Hình 37: Do  $A_v = 55.877\text{ db} = 622.08V/V$  (tòan mạch).

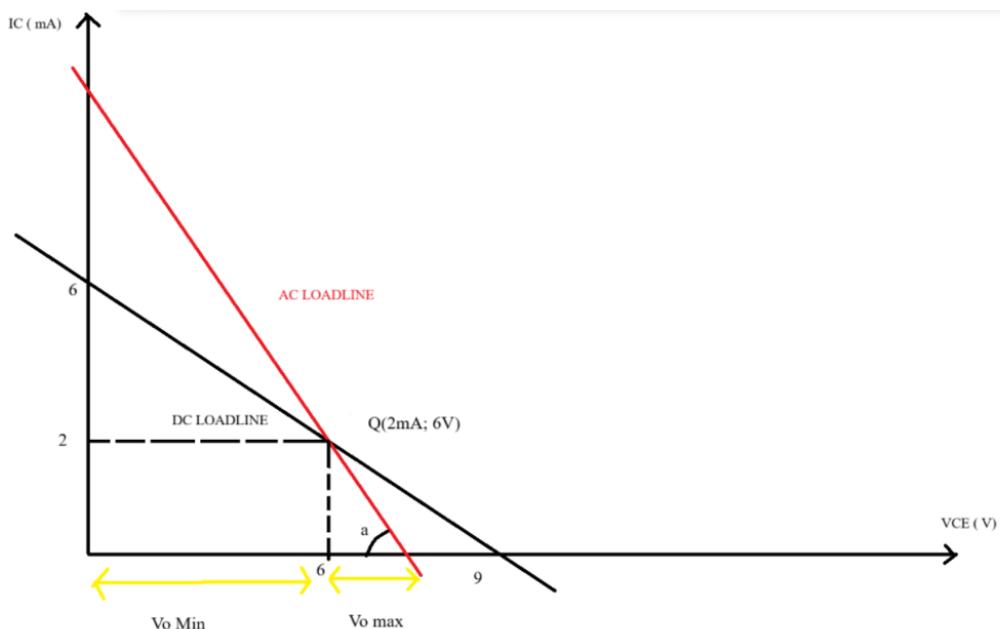


Hình 38: Do  $G_v = 29.154\text{ db} = 28.69V/V$  tại tần số  $4.266\text{ kHz}$ ( toàn mạch).

c ) Tìm biên độ lớn nhất của  $V_m$  để  $v_s$  là tín hiệu nhỏ ở cả hai tầng.

Xét Q2 ta có:

- DC load line:  $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_{C2} + R_{E2}) \rightarrow V_{CE} = 9 - I_C \times 6$
- Ac load line:  $v_{ce} = -i_c(R_{C2}/R_L) \Rightarrow v_{ce} = -i_c \times 0.5$  và đường này cũng phải cắt qua điểm  $I_{CQ2}$ , được mô tả như hình dưới đây.

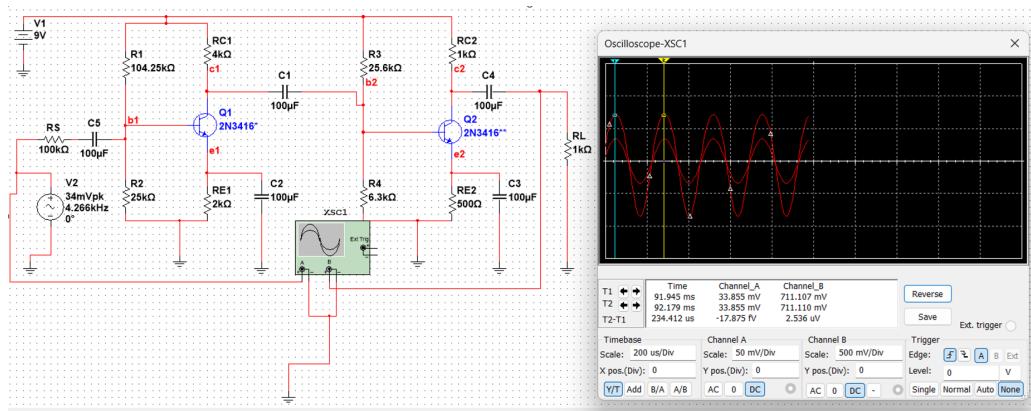


$$\tan(\alpha) = \frac{1}{R_L//R_C} = \frac{1}{0.5 \text{ k}\Omega}$$

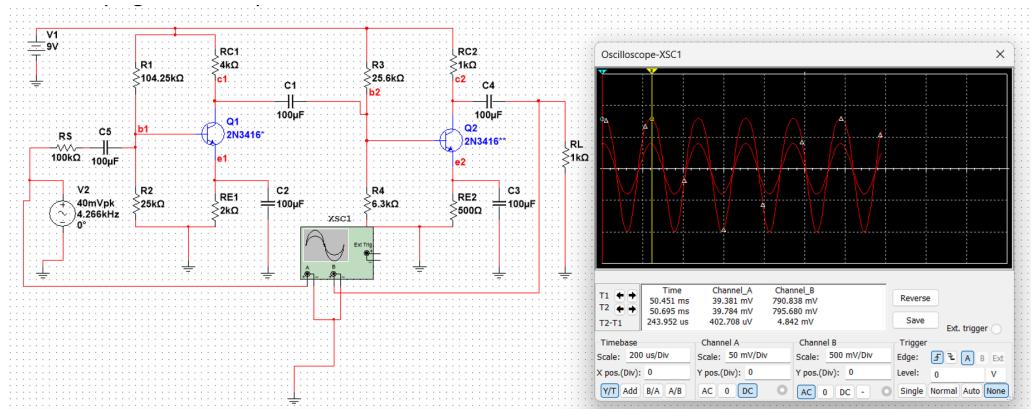
$$\Rightarrow V_{o_{\max}} = \frac{I_{CQ2}}{\tan(\alpha)} = 1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig(max)}} = \frac{V_{o_{\max}}}{G_V(f = 4.266 \text{ kHz})} = \frac{1}{28.69} = 34 \text{ mV}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig(max)}} = 34 \text{ mV} .$$



Hinh 39:  $V_{p_{sig}} = 34mV$ ;  $V_{p_L} = 711mV$ ;  $G_v = 21.54V/V$ .



Hinh 40:  $V_{p_{sig}} = 40mV$ ;  $V_{p_L} = 790.68mV$ ;  $G_v = 19.767V/V$ .